

日本国特許庁
JAPAN PATENT OFFICE

PCT/JP 2004/010710

29.07.2004

#2

別紙添付の書類に記載されている事項は下記の出願書類に記載されている事項と同一であることを証明する。

This is to certify that the annexed is a true copy of the following application as filed with this Office.

出願年月日
Date of Application: 2003年 7月31日

出願番号
Application Number: 特願2003-283567
[ST. 10/C]: [JP 2003-283567]

REC'D 16 SEP 2004	
WIPO	PCT

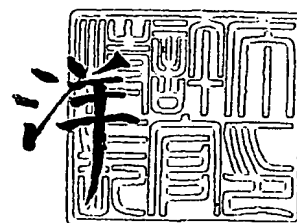
出願人
Applicant(s): TDK株式会社

**PRIORITY
DOCUMENT**
SUBMITTED OR TRANSMITTED IN
COMPLIANCE WITH RULE 17.1(a) OR (b)

2004年 9月 2日

特許庁長官
Commissioner,
Japan Patent Office

小川



BEST AVAILABLE COPY

出証番号 出証特2004-3078822

【書類名】 特許願
【整理番号】 99P05554
【提出日】 平成15年 7月31日
【あて先】 特許庁長官 殿
【国際特許分類】 G11B 5/84
C23F 4/00

【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 T D K株式会社内
【氏名】 服部 一博

【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 T D K株式会社内
【氏名】 高井 充

【発明者】
【住所又は居所】 東京都中央区日本橋一丁目 1 3 番 1 号 T D K株式会社内
【氏名】 大川 秀一

【特許出願人】
【識別番号】 000003067
【氏名又は名称】 T D K株式会社

【代理人】
【識別番号】 100076129
【弁理士】
【氏名又は名称】 松山 圭佑

【選任した代理人】
【識別番号】 100080458
【弁理士】
【氏名又は名称】 高矢 諭

【選任した代理人】
【識別番号】 100089015
【弁理士】
【氏名又は名称】 牧野 剛博

【手数料の表示】
【予納台帳番号】 006622
【納付金額】 21,000円

【その他】 平成15年6月27日付で名称変更届を提出しております。

【提出物件の目録】
【物件名】 特許請求の範囲 1
【物件名】 明細書 1
【物件名】 図面 1
【物件名】 要約書 1

【書類名】特許請求の範囲

【請求項 1】

基板表面上に連続記録層、マスク層、レジスト層をこの順で形成してなる被加工体の前記レジスト層を所定のパターン形状に加工するレジスト層加工工程と、前記レジスト層に基づいて前記マスク層を前記パターン形状に加工するマスク層加工工程と、前記マスク層上の前記レジスト層を除去するレジスト層除去工程と、前記マスク層に基づいてドライエッチングにより前記連続記録層を前記パターン形状に加工し、多数の分割記録要素に分割する連続記録層加工工程と、を含んでなり、前記連続記録層加工工程の前に前記レジスト層除去工程を実行するようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 2】

請求項 1 において、

前記マスク層の材料を前記連続記録層加工工程におけるエッチングレートが前記連続記録層よりも低い材料とし、前記マスク層を前記連続記録層よりも薄く形成したことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 3】

請求項 1 又は 2 において、

前記マスク層の厚さを 15 nm 以下としたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 4】

請求項 1 又は 2 において、

前記マスク層の厚さを 10 nm 以下としたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 5】

請求項 1 乃至 4 のいずれかにおいて、

前記連続記録層加工工程は、イオンビームエッチングを用いて前記連続記録層を加工するようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 6】

請求項 1 乃至 5 のいずれかにおいて、

前記マスク層の材料をダイヤモンドライクカーボンとしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 7】

請求項 1 乃至 6 のいずれかにおいて、

前記マスク層を第 1 のマスク層として、該第 1 のマスク層と、前記レジスト層と、の間に、前記レジスト層除去工程におけるエッチングレートが前記第 1 のマスク層よりも低い材料の第 2 のマスク層を形成し、前記マスク層加工工程は、前記レジスト層に基づいて前記第 2 のマスク層を前記パターン形状に加工する第 2 のマスク層加工工程と、該第 2 のマスク層に基づいて前記第 1 のマスク層を前記パターン形状に加工する第 1 のマスク層加工工程と、を含む構成としたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 8】

請求項 7 において、

前記レジスト層除去工程が前記第 1 のマスク層加工工程を兼ねるようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 9】

請求項 8 において、

前記レジスト層除去工程は、酸素及びオゾンのいずれかを反応ガスとする反応性イオンエッチングを用いて前記レジスト層を除去すると共に前記マスク層を加工するようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 10】

請求項 8 又は 9 において、

前記連続記録層加工工程で前記第 1 のマスク層上の前記第 2 のマスク層が除去されるように、該第 2 のマスク層は、膜厚が十分に薄い構成、及び／又は材料が前記連続記録層加工工程において前記連続記録層の材料よりも高いエッチングレートを有する材料である構

成としたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 11】

請求項 8 乃至 10 のいずれかにおいて、

前記第 2 のマスク層の材料をケイ素及びケイ素の化合物の少なくとも一方からなるケイ素系材料としたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 12】

請求項 8 乃至 11 のいずれかにおいて、

前記第 2 のマスク層加工工程は、フッ素系ガスを反応ガスとする反応性イオンエッチングを用いて前記第 2 のマスク層を加工するようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 13】

請求項 1 乃至 12 のいずれかにおいて、

前記レジスト層加工工程は、インプリント法を用いて前記レジスト層を加工するようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 14】

請求項 1 乃至 13 のいずれかにおいて、

前記被加工体を複数同時に加工するようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 15】

基板表面上に連続記録層、マスク層、レジスト層をこの順で形成してなる被加工体の前記レジスト層を所定のパターン形状に加工するレジスト層加工工程と、前記レジスト層に基づいて前記マスク層を前記パターン形状に加工するマスク層加工工程と、前記マスク層上の前記レジスト層を除去するレジスト層除去工程と、前記マスク層に基づいてイオンビームエッチングにより前記連続記録層を前記パターン形状に加工し、多数の分割記録要素に分割する連続記録層加工工程と、を含んでなり、前記連続記録層加工工程の前に前記レジスト層除去工程を実行するようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【請求項 16】

請求項 1 乃至 15 のいずれかに記載の磁気記録媒体の製造方法を実行するための加工装置と、複数の前記被加工体を同時に保持するためのホルダと、を備え、複数の前記被加工体を同時に加工可能としたことを特徴とする磁気記録媒体の製造装置。

【請求項 17】

請求項 16 において、

前記連続記録層を加工するためのイオンビームエッチング装置を備えることを特徴とする磁気記録媒体の製造装置。

【書類名】明細書

【発明の名称】磁気記録媒体の製造方法及び製造装置

【技術分野】

【0001】

本発明は、磁気記録媒体の製造方法及び製造装置に関する。

【背景技術】

【0002】

従来、ハードディスク等の磁気記録媒体は、記録層を構成する磁性粒子の微細化、材料の変更、ヘッド加工の微細化等の改良により著しい面記録密度の向上が図られており、今後一層の面記録密度の向上が期待されている。

【0003】

しかしながら、ヘッドの加工限界、磁界の広がり起因するサイドフリンジ、クロストーク等の問題が顕在化し、従来の改良手法による面記録密度の向上は限界にきており、一層の面記録密度の向上を実現可能である磁気記録媒体の候補として、連続記録層を多数の分割記録要素に分割してなるディスクリットタイプの磁気記録媒体が提案されている（例えば、特許文献1参照）。

【0004】

連続記録層の微細な分割を実現する加工技術としては、イオンビームエッチング、 NH_3 （アンモニア）ガス等の含窒素ガスが添加された CO （一酸化炭素）ガスを反応ガスとする反応性イオンエッチング（例えば、特許文献2参照）等のドライエッチングの手法を利用する。

【0005】

尚、ドライエッチングのマスク層を所定のパターンに加工する手法としてはレジスト層を用いたリソグラフィ等の半導体製造の分野で用いられている手法を利用する。

【0006】

【特許文献1】特開平9-97419号公報

【特許文献2】特開平12-322710号公報

【発明の開示】

【発明が解決しようとする課題】

【0007】

しかしながら、反応性イオンエッチング等の従来のドライエッチングの手法を用いることで、連続記録層を微細なパターンで多数の分割記録要素に分割することはできても、磁気記録媒体上の部位により分割記録要素の加工精度がばらついたり分割記録要素が過度に加熱されて磁氣的に劣化することがある。又、分割記録要素の周縁部に沿ってバリのような段部が形成されたり、側面がテーパ形状の分割記録要素が形成され、所望の加工形状と、実際の加工形状と、の間に、一定のずれが生じることがある。このような磁氣的劣化や分割記録要素の加工形状のずれのために、所望の磁気特性が得られないことがある。

【0008】

例えば、反応性イオンエッチングは、被加工体の端部近傍でプラズマの分布が不安定となる傾向があり、端部近傍で分割記録要素の加工精度が低くなりやすい傾向がある。

【0009】

又、磁性材の加工に用いられる CO （一酸化炭素）ガス等を反応ガスとする反応性イオンエッチングは大きなバイアスパワーを要し、被加工体が高温になりやすいため、分割記録要素が過度に加熱されて磁氣的に劣化することがある。

【0010】

尚、冷却機構を設けることで、分割記録要素の過度の加熱を防止するが、製造装置の構造が複雑となり、コスト高であると共に、被加工体の周縁近傍でプラズマの分布が不安定となる傾向があるため、温度分布が不均一になりやすく、被加工体の均一な冷却が困難である。

【0011】

又、磁気記録媒体の量産を図るためには、複数の被加工体を並べて配置し、同時に加工することが望ましいが、冷却機構は一般的にESC（静電チャック）やバイアス印加機構を備えているため、複数の被加工体を並べて配置した場合、このような冷却機構を設けること自体がスペース、加工精度等の事情により困難であり、被加工体の冷却を必要とする反応性イオンエッチングを用いて複数の被加工体を同時処理し、ディスクリットタイプの磁気記録媒体を量産することは困難であった。

【0012】

これに対し、イオンビームエッチングを用いれば以上の問題を解決しうるが、イオンビームエッチングを用いた場合、分割記録要素の周縁部に沿ってバリのような段部が形成されやすいという問題がある。

【0013】

より詳細に説明すると図22(A)に示されるように連続記録層100におけるマスク102から露出した部分をイオンビームエッチングで加工する場合、連続記録層100の除去と、除去された粒子の一部のマスク102の側面102A等への再付着と、が繰返され、再付着物は量が少なければイオンビームで逐次除去されるが、量が多いと図22(B)に示されるように一部がマスク102の側面102Aに堆積し、結果的に図22(C)に示されるように分割記録要素104の周縁部に段部106が形成されることになる。この現象はドライエッチング一般に関して発生しうるが、特にイオンビームエッチングで顕著である。尚、この現象を抑制するために被加工体の表面の法線に対して傾斜した方向からイオンビーム等を照射することにより加工部側面等から再付着物を効率良く除去する手法が知られているが、ディスクリットタイプの磁気記録媒体のようにパターンが微細である場合には有効ではない。

【0014】

又、ドライエッチングを用いた場合、図23(A)に示されるように側面200Aが垂直に近い理想的な形状の分割記録要素200を形成することは困難で、実際には図23(B)に示されるように側面200Aがテーパ形状の分割記録要素200が形成されていた。

【0015】

より詳細に説明すると、ドライエッチングでは、一部のガスが被加工体に対して垂直方向から若干傾斜して接近し、エッチング対象領域の端部はマスク202から露出しているも傾斜して接近するガスに対してマスク202の陰となるため、他の部分よりもエッチングの進行が遅れ、分割記録要素200の側面200Aがテーパ形状に加工されると考えられる。

【0016】

本発明は、以上の問題点に鑑みてなされたものであって、分割記録要素の加工形状のずれ、磁気的な劣化を抑制し、良好な磁気特性を有する磁気記録媒体を効率良く製造することができる磁気記録媒体の製造方法及び製造装置を提供することをその課題とする。

【課題を解決するための手段】

【0017】

本発明は、連続記録層のドライエッチング手法としてイオンビームエッチングを用いることで被加工体の端部近傍における連続記録層の加工精度の低下を抑制すると共に連続記録層の加工温度を抑制し、分割記録要素の磁気的劣化を防止又は低減するものである。

【0018】

又、本発明は、連続記録層を被覆するマスク層上のレジスト層を連続記録層のドライエッチングの前に除去することにより連続記録層上の被覆要素を薄くして、周縁部の段部の形成、分割記録要素の側面のテーパ角、を抑制し、分割記録要素の加工精度を向上させるものである。

【0019】

尚、連続記録層を被覆するマスク層の材料としては、イオンビームエッチングに対してエッチングレートが低く、それだけ薄く形成できるという点及び加工形状の制御が比較的

容易であるというダイヤモンドライクカーボンを用いるが好ましい。

【0020】

ここで、本明細書において「ダイヤモンドライクカーボン（以下、「DLC」という）」という用語は、炭素を主成分とし、アモルファス構造であって、ビッカース硬度測定で $200 \sim 8000 \text{ kgf/mm}^2$ 程度の硬さを示す材料という意義で用いることとする。

【0021】

又、本明細書において、「イオンビームエッチング」という用語は、例えばイオンミリング等の、イオン化したガスを被加工体に照射して除去する加工方法の総称という意義で用いることとし、イオンビームを絞って照射する加工方法に限定しない。

【0022】

更に、本明細書において「磁気記録媒体」という用語は、情報の記録、読み取りに磁気のみを用いるハードディスク、フロッピー（登録商標）ディスク、磁気テープ等に限定されず、磁気と光を併用するMO（Magnet Optical）等の光磁気記録媒体、磁気と熱を併用する熱アシスト型の記録媒体も含む意義で用いることとする。

【0023】

即ち、次のような本発明により、上記課題の解決を図ったものである。

【0024】

(1) 基板表面上に連続記録層、マスク層、レジスト層をこの順で形成してなる被加工体の前記レジスト層を所定のパターン形状に加工するレジスト層加工工程と、前記レジスト層に基づいて前記マスク層を前記パターン形状に加工するマスク層加工工程と、前記マスク層上の前記レジスト層を除去するレジスト層除去工程と、前記マスク層に基づいてドライエッチングにより前記連続記録層を前記パターン形状に加工し、多数の分割記録要素に分割する連続記録層加工工程と、を含んでなり、前記連続記録層加工工程の前に前記レジスト層除去工程を実行するようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【0025】

(2) 前記マスク層の材料を前記連続記録層加工工程におけるエッチングレートが前記連続記録層よりも低い材料とし、前記マスク層を前記連続記録層よりも薄く形成したことを特徴とする前記(1)の磁気記録媒体の製造方法。

【0026】

(3) 前記マスク層の厚さを 15 nm 以下としたことを特徴とする前記(1)又は(2)の磁気記録媒体の製造方法。

【0027】

(4) 前記マスク層の厚さを 10 nm 以下としたことを特徴とする前記(1)又は(2)の磁気記録媒体の製造方法。

【0028】

(5) 前記連続記録層加工工程は、イオンビームエッチングを用いて前記連続記録層を加工するようにしたことを特徴とする前記(1)乃至(4)のいずれかの磁気記録媒体の製造方法。

【0029】

(6) 前記マスク層の材料をダイヤモンドライクカーボンとしたことを特徴とする前記(1)乃至(5)のいずれかの磁気記録媒体の製造方法。

【0030】

(7) 前記マスク層を第1のマスク層として、該第1のマスク層と、前記レジスト層と、の間に、前記レジスト層除去工程におけるエッチングレートが前記第1のマスク層よりも低い材料の第2のマスク層を形成し、前記マスク層加工工程は、前記レジスト層に基づいて前記第2のマスク層を前記パターン形状に加工する第2のマスク層加工工程と、該第2のマスク層に基づいて前記第1のマスク層を前記パターン形状に加工する第1のマスク層加工工程と、を含む構成としたことを特徴とする前記(1)乃至(6)のいずれかの磁気記録媒体の製造方法。

【0031】

(8) 前記レジスト層除去工程が前記第1のマスク層加工を兼ねるようにしたことを特徴とする前記(7)の磁気記録媒体の製造方法。

【0032】

(9) 前記レジスト層除去工程は、酸素及びオゾンのいずれかを反応ガスとする反応性イオンエッチングを用いて前記レジスト層を除去すると共に前記マスク層を加工するようにしたことを特徴とする前記(8)の磁気記録媒体の製造方法。

【0033】

(10) 前記連続記録層加工工程で前記第1のマスク層上の前記第2のマスク層が除去されるように、該第2のマスク層は、膜厚が十分に薄い構成、及び／又は材料が前記連続記録層加工工程において前記連続記録層の材料よりも高いエッチングレートを有する材料である構成としたことを特徴とする前記(8)又は(9)の磁気記録媒体の製造方法。

【0034】

(11) 前記第2のマスク層の材料をケイ素及びケイ素の化合物の少なくとも一方からなるケイ素系材料としたことを特徴とする前記(8)乃至(10)のいずれかの磁気記録媒体の製造方法。

【0035】

(12) 前記第2のマスク層加工工程は、フッ素系ガスを反応ガスとする反応性イオンエッチングを用いて前記第2のマスク層を加工するようにしたことを特徴とする前記(8)乃至(11)のいずれかの磁気記録媒体の製造方法。

【0036】

(13) 前記レジスト層加工工程は、インプリント法を用いて前記レジスト層を加工するようにしたことを特徴とする前記(1)乃至(12)のいずれかの磁気記録媒体の製造方法。

【0037】

(14) 前記被加工体を複数同時に加工するようにしたことを特徴とする前記(1)乃至(13)のいずれかの磁気記録媒体の製造方法。

【0038】

(15) 基板表面上に連続記録層、マスク層、レジスト層をこの順で形成してなる被加工体の前記レジスト層を所定のパターン形状に加工するレジスト層加工工程と、前記レジスト層に基づいて前記マスク層を前記パターン形状に加工するマスク層加工工程と、前記マスク層上の前記レジスト層を除去するレジスト層除去工程と、前記マスク層に基づいてイオンビームエッチングにより前記連続記録層を前記パターン形状に加工し、多数の分割記録要素に分割する連続記録層加工工程と、を含んでなり、前記連続記録層加工工程の前に前記レジスト層除去工程を実行するようにしたことを特徴とする磁気記録媒体の製造方法。

【0039】

(16) 前記(1)乃至(15)のいずれかに記載の磁気記録媒体の製造方法を実行するための加工装置と、複数の前記被加工体を同時に保持するためのホルダと、を備え、複数の前記被加工体を同時に加工可能としたことを特徴とする磁気記録媒体の製造装置。

【0040】

(17) 前記連続記録層を加工するためのイオンビームエッチング装置を備えることを特徴とする前記(16)の磁気記録媒体の製造装置。

【発明の効果】

【0041】

本発明によれば、分割記録要素の加工形状のずれ、分割記録要素の磁気的な劣化を抑制し、良好な磁気特性の磁気記録媒体を効率良く確実に製造することが可能となるという優れた効果がもたらされる。

【発明を実施するための最良の形態】

【0042】

以下、本発明の好ましい実施形態について図面を参照して詳細に説明する。

【0043】

本実施形態は、磁気記録媒体の加工出発体である図1に示されるような被加工体にドライエッチング等の加工を施し、図2に示されるような所定のラインアンドスペースパターン及びコンタクトホールを含むサーボパターン（図示省略）の形状に連続記録層を加工して多数の分割記録要素に分割する磁気記録媒体の製造方法に関するものであり、連続記録層の加工手法の他、連続記録層を被覆するマスク層、レジスト層の材料及びその加工方法等に特徴を有している。又、本実施形態は、これら連続記録層の加工手法等を実施し、磁気記録媒体を量産するための磁気記録媒体の製造装置に特徴を有している。他の構成については従来の磁気記録媒体の製造方法、製造装置と同様であるので説明を適宜省略することとする。

【0044】

被加工体10は、中心孔を有する略円板形状（図示省略）であり、図1に示されるように、ガラス基板12に、下地層14、軟磁性層16、配向層18、連続記録層20、第1のマスク層22、第2のマスク層24、レジスト層26がこの順で形成された構造とされている。

【0045】

下地層14の材料はCr（クロム）又はCr合金、軟磁性層16の材料はFe（鉄）合金又はCo（コバルト）合金、配向層18の材料はCoO、MgO、NiO等、連続記録層20の材料はCo（コバルト）合金である。又、第1のマスク層22の材料はDLC、第2のマスク層24の材料はSi（ケイ素）、レジスト層26の材料はネガ型レジスト（NEB22A 住友化学工業株式会社製）である。

【0046】

図2に示されるように、磁気記録媒体30は垂直記録型のディスクリットタイプの磁気ディスクで、前記連続記録層20がトラックの径方向に微細な間隔で多数の分割記録要素31に分割されると共に、分割記録要素31の間の溝部33に非磁性体32が充填され、分割記録要素31及び非磁性体32に保護層34、潤滑層36がこの順で形成された構造とされている。尚、分割記録要素31と非磁性体32の間には隔膜38が形成されている。

【0047】

非磁性体32の材料はSiO₂（二酸化ケイ素）、保護層34及び隔膜38の材料はいずれも前述のDLCと呼称される硬質炭素膜、潤滑層36の材料はPFPE（パーフロロポリエーテル）である。

【0048】

図3に示されるように、磁気記録媒体の製造装置40は、転写手段42と、アッシング装置44と、反応性イオンエッチング装置46及び48と、イオンビームエッチング装置50と、アッシング装置52と、ドライ洗浄手段54と、隔膜形成手段56と、非磁性体充填手段58と、平坦化手段60と、保護層形成手段62と、潤滑層36を形成するための潤滑層形成手段64と、を備えている。

【0049】

又、製造装置40は、アッシング装置44、反応性イオンエッチング装置46、48、イオンビームエッチング装置50、アッシング装置52、ドライ洗浄手段54、隔膜形成手段56、非磁性体充填手段58、平坦化手段60及び保護層形成手段62を収容して被加工体10の周囲を真空状態に保持するための真空保持手段66を備えている。

【0050】

更に、製造装置40は、複数の被加工体10を同時に保持するための図4に示されるようなホルダ68と、ホルダ68を自動搬送するための図示しない自動搬送装置と、を備え、複数の被加工体10を同時に加工可能とされている。

【0051】

転写手段42は、リソグラフィ等で作成された型（図示省略）をレジスト層26にプレスしてレジスト層26に所定のパターンを転写し、溝を形成するためのナノ・インプリン

ト法を用いたプレ配置である。

【0052】

アッシング装置44は、酸素、オゾン又はそれらのガスのプラズマを用いたアッシングによりナノ・インプリント時に残存した溝底面のレジスト層26を除去するように構成されている。

【0053】

反応性イオンエッチング装置46は、 CF_4 （4フッ化炭素）ガス又は SF_6 （6フッ化硫黄）ガス等のフッ素系ガスを反応性ガスとする反応性イオンエッチングにより溝底面の第2のマスク層24を除去するように構成されている。

【0054】

具体的には図5に示されるように、反応性イオンエッチング装置46はヘリコン波プラズマ方式であり、拡散チャンバー46Aと、拡散チャンバー46A内にホルダ68を載置するためのESC（静電チャック）ステージ電極46Bと、プラズマを発生するための石英製ベル・ジャー46Cと、を備えている。

【0055】

ESCステージ電極46Bにはバイアス電圧を印加するためのバイアス電源46Dが結線されている。尚、バイアス電源は、周波数が1.6MHzの交流電源である。

【0056】

石英製ベル・ジャー46Cは下端が拡散チャンバー46A内に開口し、下部近傍には反応ガスを給気するための給気孔46Eが設けられている。又、石英製ベル・ジャー46Cの周囲には、電磁コイル46Fと、アンテナ46Gが配設され、アンテナ46Gにはプラズマ発生電源46Hが結線されている。尚、プラズマ発生電源46Hは、周波数が13.56MHzの交流電源である。

【0057】

反応性イオンエッチング装置48は、酸素又はオゾンを経反応性ガスとする反応性イオンエッチングにより溝以外の領域のレジスト層26を除去すると共に、溝底面の第1のマスク層を除去するように構成されている。尚、反応性イオンエッチング装置48は上記反応性イオンエッチング装置46に対し、反応ガスの種類が異なるのみで構造は同様である。

【0058】

イオンビームエッチング装置50は、Ar（アルゴン）ガスを用いたイオンビームエッチングにより溝底面の連続記録層20を除去して多数の分割記録要素31に分割するように構成されている。

【0059】

具体的にはイオンビームエッチング装置50は、図6に示されるように、真空チャンバー50Aと、真空チャンバー50A内にホルダ68を載置するためのESC（静電チャック）ステージ電極50Bと、イオンを発生してステージ電極50Bに照射するためのイオンガン50Cと、イオンガン50Cにアルゴンガスを供給するためのガス供給部50Dと、イオンガン50Cにビーム電圧を印加するための電源50Eと、を備えている。尚、真空チャンバー50Aには、アルゴンガスを排出するための排出孔50Fが設けられている。

【0060】

イオンガン50Cは、電源50Eに結線された陽極50Gと、陰極50Hと、を備えている。陰極50Hには多数の微細孔50Jが設けられており、該微細孔50Jからイオン化したアルゴンガスを放出・照射するように構成されている。

【0061】

アッシング装置52は、酸素、オゾン又はそれらのガスのプラズマを用いたアッシングにより分割記録要素31上に残存する第1のマスク層22を除去するように構成されている。

【0062】

ドライ洗浄手段54は、プラズマを用いて分割記録要素31の周囲の異物を除去するよ

うに構成されてい

【0063】

隔膜形成手段56は、分割記録要素31にDLCの隔膜38をCVD (Chemical Vapor Deposition) により形成するためのCVD装置である。

【0064】

非磁性体充填手段58は、バイアスパッタリングによりSiO₂の非磁性体32を分割記録要素31の間の溝部33に非磁性体32を充填するためのバイアスパッタリング装置である。

【0065】

平坦化手段60は、Arガスを用いたイオンビームエッチングにより媒体表面を平坦化するためのイオンビームエッチング装置である。

【0066】

保護層形成手段62は、DLCの保護層34をCVD法により分割記録要素31及び非磁性体32に形成するためのCVD装置である。

【0067】

潤滑層形成手段64は、PFPEの潤滑層36を保護層34にディッピングにより塗布するためのディッピング装置である。

【0068】

真空保持手段66は、真空槽70と、該真空槽70に連通する真空ポンプ72と、を有して構成されている。

【0069】

ホルダ68は、略円板形状で導電性を有し、被加工体10が遊嵌して保持される複数の円形凹部68Aが形成されている。各円形凹部68Aの中心近傍には円形段部68Bが形成されており、中心孔を有する被加工体10が内周及び外周において遊嵌するように構成されている。

【0070】

次に、図7に示されるフローチャート等を参照して磁気記録媒体の製造装置40の作用について説明する。

【0071】

まず、被加工体10を用意する。被加工体10はガラス基板12に、下地層14を30～2000nmの厚さで、軟磁性層16を50～300nmの厚さで、配向層18を3～30nmの厚さで、連続記録層20を5～30nmの厚さで、第1のマスク層22を3～20nmの厚さで、第2のマスク層24を3～15nmの厚さで、この順でスパッタリングにより形成し、更にレジスト層26を30～300nmの厚さで、スピコート又はディッピングにより形成して得られる。尚、第1のマスク層22は連続記録層20よりも薄く形成することが好ましい。例えば、連続記録層20を20nm程度の厚さに形成した場合、第1のマスク層22を15nm以下の厚さに形成することが好ましい。

【0072】

この被加工体10のレジスト層26に転写手段42を用いて、図8に示されるような分割記録要素31の分割パターンに相当する溝をインプリント法により転写する。このようにインプリント法を用いることで、分割パターンに相当する溝を被加工体10に効率良く転写することができる。尚、リソグラフィ等により、被加工体10に分割パターンに相当する溝を転写することも当然可能である。このように溝を形成した複数の被加工体10をホルダ68に装着し、真空槽70内に搬入する。搬入されたホルダ68は図示しない搬送装置により、真空槽70内の各加工装置に自動搬送され、複数の被加工体10が同時に加工される。

【0073】

まず、アッシング装置44が、図9に示されるように溝底面のレジスト層26を除去する(S102)。尚、レジスト層26は溝以外の領域も除去されるが、溝底面との段差の分だけ残存する。

【0074】

次に、反応性イオンエッチング装置46が、図10に示されるように溝底面の第2のマスク層24を除去する(S104)。尚、この際第1のマスク層22も微量除去される。又、溝以外の領域のレジスト層26も若干除去されるが残存する。尚、第2のマスク層24の加工には、反応性ガスとしてフッ素系ガスを用いているので、反応性ガスとして塩素系ガスを用いる場合のように、水等を用いたウェット洗浄を必ずしも必要とせず、後述するようにドライ洗浄で足りる。従って、被加工体10の加工工程を総てドライ工程とすることが可能となり生産効率の向上に寄与する。

【0075】

次に、反応性イオンエッチング装置48が、溝底面の第1のマスク層22を除去すると共に、図11に示されるように溝以外の領域のレジスト層26を除去する(S106)。又、溝以外の領域の第2のマスク層24も若干除去されるが大部分が残存する。第1のマスク層22は材料がDLC、レジスト層26は材料が樹脂のレジスト材料であり、いずれも酸素を反応ガスとする反応性イオンエッチングに対するエッチングレートが高いので、このように、溝底面の第1のマスク層22の除去及び溝以外の領域のレジスト層26の除去を同時に行うことができ、生産効率がよい。

【0076】

尚、酸素を反応ガスとする反応性イオンエッチングに対するエッチングレートが低いケイ素を材料とする第2のマスク層24が第1のマスク層22の上に形成されているので、溝以外の領域の第1のマスク層22は良好な形状で残存する。

【0077】

このように、第1のマスク層22及び第2のマスク層24の2層のマスク層を設けることで、マスク材料、反応ガスの種類の選択幅を広げることができる。

【0078】

次に、イオンビームエッチング装置50が、図12に示されるように溝底面の連続記録層20を除去し、これにより連続記録層20が多数の分割記録要素31に分割され、分割記録要素31の間に溝部33が形成される(S108)。

【0079】

ここで、溝以外の領域の第2のマスク層24は完全に除去され、溝以外の領域の第1のマスク層22も大部分が除去されるが微量が分割記録要素31の上面に残存しうる。

【0080】

第1のマスク層22は材料がDLCであるためイオンビームエッチングに対するエッチングレートが連続記録層20よりも低く、それだけ膜厚が薄くて足りる。又、第2のマスク層24は材料がケイ素であるためイオンビームエッチングに対するエッチングレートが連続記録層20よりも高いため短時間で除去される。尚、レジスト層除去工程、兼第1のマスク層加工工程(S106)において残存できる範囲で第2のマスク層24を極力薄く形成すれば、イオンビームエッチングに対するエッチングレートが連続記録層20と同等又は連続記録層20よりも低い材料を用いた場合も、短時間で第2のマスク層を除去することが可能である。更に、第2のマスク層24上のレジスト層26は既に除去されている。即ち、連続記録層20を被覆する被覆要素は実質的に薄くなっているため、被加工体10の表面の法線に対して傾斜した方向から照射されるイオンビームの陰となる部分が小さく、分割記録要素31の側面のテーパ角をそれだけ抑制することができる。

【0081】

又、連続記録層20を被覆する被覆要素が薄いため、イオンビームエッチングにおいて被覆要素の側面の再付着物がそれだけ少なく、分割記録要素31の周縁部におけるエッジ状の段部の発生を防止又は低減することができる。尚、分割記録要素31上の第1のマスク層の残存量が極力少なくなるように第1のマスク層の膜厚、イオンビームエッチングの設定条件等を調整すれば、それだけ第1のマスク層の側面の再付着物を低減し、分割記録要素31の周縁部におけるエッジ状の段部の発生を更に抑制することができる。

【0082】

又、イオンビームエッチングは、反応性イオンエッチングに対し、加工精度が被加工体 10 の形状に依存しにくく、複数の被加工体 10 の全領域を均一に高精度で加工することができる。

【0083】

又、イオンビームエッチングは、CO ガス等を反応ガスとする反応性イオンエッチングよりも加工温度が低いので過度の加熱による分割記録要素 31 の磁氣的劣化を防止又は低減することができる。

【0084】

又、イオンビームエッチングは、CO ガス等を反応ガスとする反応性イオンエッチングよりも磁性材料に対するエッチングの進行が速く、微細なパターンに対するエッチング速度の形状依存性が低い為、生産効率がよい。

【0085】

尚、連続記録層 20 の加工において、配向層 18 も若干除去されうる。

【0086】

次に、アッシング装置 52 が、分割記録要素 31 上に残存する第 1 のマスク層 22 を、図 13 に示されるように完全に除去する (S110)。

【0087】

ここで、ドライ洗浄手段 54 を用いて分割記録要素 31 の表面の異物を除去する (S112)。

【0088】

次に、図 14 に示されるように、隔膜形成手段 56 が、分割記録要素 31 に DLC の隔膜 38 を 1~20 nm の厚さで成膜し (S114)、更に非磁性体充填手段 58 が、分割記録要素 31 の間の溝部 33 に非磁性体 32 を充填する (S116)。ここで、非磁性体 32 は隔膜 38 を完全に被覆するように成膜する。尚、分割記録要素 31 は隔膜 38 で被覆・保護されているので、非磁性体 32 のバイアスパッタリングにより劣化することがない。

【0089】

次に、平坦化手段 60 が、非磁性体 32 を、図 15 に示されるように分割記録要素 31 の上面まで除去し、分割記録要素 31 及び非磁性体 32 の表面を平坦化する (S118)。この際、高精度な平坦化を行うためには Ar イオンの入射角は $-10 \sim 15^\circ$ の範囲とすることが好ましい。一方、非磁性体充填工程で分割記録要素 31 及び非磁性体 32 の表面の良好な平坦性が得られていれば、Ar イオンの入射角は $30 \sim 90^\circ$ の範囲とするとよい。このようにすることで、加工速度が速くなり、生産効率を高めることができる。ここで「入射角」とは、被加工体の表面に対する入射角度であって、被加工体の表面とイオンビームの中心軸とが形成する角度という意味で用いることとする。例えば、イオンビームの中心軸が被加工体の表面と平行である場合、入射角は 0° である。尚、分割記録要素 31 上の隔膜 38 は完全に除去してもよいし、一部を残してもよいが、分割記録要素 31 の上面の非磁性体 32 は完全に除去する。

【0090】

次に、保護層形成手段 62 が、CVD 法により分割記録要素 31 及び非磁性体 32 の上面に 1~5 nm の厚さで DLC の保護層 34 を形成する (S120)。ここで、ホルダ 68 を真空槽 70 から搬出し、ホルダ 68 から各被加工体 10 を取外す。

【0091】

更に、潤滑層形成手段 64 を用いてディッピングにより保護層 34 の上に 1~2 nm の厚さで PFP E の潤滑層 36 を塗布する (S122)。これにより、前記図 2 に示される磁気記録媒体 30 が完成する。

【0092】

以上のように、連続記録層 20 の加工にイオンビームエッチングを用いることで、磁氣的劣化を抑制しつつ被加工体を均一に高精度で加工することができる。更に、連続記録層 20 の加工温度が高い場合、磁氣的劣化を制限するために冷却機構が必要である一方、前

述のように複数の被加工体を同時に加工する場合、スペース、加工精度等の事情によりESC（静電チャック）やバイアス印加機構を備えた冷却機構を設けること自体が困難であるが、連続記録層20の加工にイオンビームエッチングを用いることで連続記録層20の加工温度を低減することができ、冷却機構の設置が不要となる。これにより、複数の被加工体を同時に高精度で加工することが可能となり、効率よくディスクリットタイプの磁気記録媒体を量産することができる。

【0093】

又、連続記録層20上の被覆要素を実質的に薄くすることで、分割記録要素を良好な形状に加工することができる。

【0094】

更に、第1のマスク層の材料としてDLCを用いることで、膜厚を薄くし、分割記録要素の加工精度を一層高めることができる。

【0095】

又、被加工体10の周囲が真空中に保持された状態で分割記録要素31の形成等が行われるので加工による酸化、腐食等の分割記録要素31の劣化を防止することができる。

【0096】

又、総ての工程がドライ工程であるのでウェット工程とドライ工程とを併用する製造工程に対して被加工体の搬送等が容易であり、磁気記録媒体の製造装置40はこの点でも生産効率がよい。

【0097】

尚、本実施形態において、連続記録層20の加工の後に、第1のマスク層22を除去しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、第1のマスク層22を除去することなく保護層34の一部として活用してもよい。

【0098】

又、本実施形態において、第1のマスク層22の材料としてDLCを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、イオンビームエッチングに対するエッチングレートが低い材料であれば第1のマスク層22の材料は他の材料としてもよい。

【0099】

又、本実施形態において、第1のマスク層22及び第2のマスク層24の2層のマスク層を連続記録層20上に形成しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、エッチング条件を適宜設定し、第1のマスク層22の材料としてイオンビームエッチングに対するエッチングレートが低く、且つ、レジスト層除去工程に対するエッチングレートが低い材料を選択すれば、第2のマスク層は省略し、1層構造のマスク層としてもよい。

【0100】

又、本実施形態において、反応性イオンエッチングを用いて溝以外の領域に残存するレジスト層26を除去しているが、本発明はこれに限定されるものではなく、他のドライエッチングの手法を用いてレジスト層26を除去してもよく、又、溶解液中でレジスト層を溶解させて除去するようにしてもよい。この場合、第1のマスク層22の材料として該溶解液に対するエッチングレートが低い材料を選択すれば、第2のマスク層は省略し、1層構造のマスク層としてもよい。

【0101】

又、本実施形態において、連続記録層20の下に下地層14、軟磁性層16が形成されているが、本発明はこれに限定されるものではなく、連続記録層20の下の層の構成は、磁気記録媒体の種類に応じて適宜変更すればよい。例えば、下地層14、軟磁性層16のいずれか一方を省略してもよい。又、基板上に連続記録層を直接形成してもよい。

【0102】

又、本実施形態において、連続記録層20の加工にイオンビームエッチングを用いているが、本発明はこれに限定されるものではなく、他のドライエッチングの手法を用いて連続記録層を加工する場合も、連続記録層の加工前にマスク層上のレジスト層を除去する等の処理を行い、連続記録層上の被覆要素を実質的に薄くすることで、分割記録要素の加工

精度を高める一定の効果が得られる。

【0103】

又、本実施形態において、磁気記録媒体30は分割記録要素31がトラックの径方向に微細な間隔で並設した垂直記録型のディスクリートの磁気ディスクであるが、本発明はこれに限定されるものではなく、分割記録要素がトラックの周方向（セクタの方向）に微細な間隔で並設された磁気ディスク、トラックの径方向及び周方向の両方向に微細な間隔で並設された磁気ディスク、分割記録要素が螺旋形状をなす磁気ディスクの製造についても本発明は当然適用可能である。又、MO等の光磁気ディスク、磁気と熱を併用する熱アシスト型の記録ディスク、更に、磁気テープ等ディスク形状以外の他のディスクリートの磁気記録媒体の製造に対しても本発明は適用可能である。

【0104】

又、本実施形態において、磁気記録媒体の製造装置40は、各工程に応じた個別の加工装置を備えているが、本発明はこれに限定されるものではなく、1台の装置で複数の工程の加工を行うようにしてもよい。例えば、溝底面のレジスト層26を除去する工程と、分割記録要素31上に残存する第1のマスク層22を除去する工程は、共通のアッシング装置で行うようにしてもよい。又、連続記録層20の加工工程と、分割記録層31及び非磁性体32の平坦化工程はArガスを用いた共通のイオンビームエッチング装置で行うようにしてもよい。又、第2のマスク層24の加工と、第1のマスク層22の加工及びレジスト層26の除去と、を共通の反応性イオンエッチング装置を用いて、反応ガスを換えて行うようにしてもよい。このようにすることで、製造装置のコンパクト化、低コスト化を図ることができる。

【実施例】

【0105】

上記実施形態により、磁気記録ディスクを作製した。尚、連続記録層20の厚さは約20nm、第1のマスク層22の厚さは約10nm、第2のマスク層24の厚さは約5nm、レジスト層26の厚さは約100nmとした。

【0106】

第2のマスク層24、第1のマスク層22、連続記録層20の加工における被加工体10の加工温度、加工に要した時間は次のとおりであった。

【0107】

第2のマスク層24：50℃以下、約5秒（反応ガスSF₆）

第1のマスク層22：50℃以下、約10秒（反応ガスO₂）

連続記録層20：約120℃以下、約30秒（Arイオンビーム）

【0108】

図16は、同磁気記録ディスクの分割記録要素の形状を拡大して示す顕微鏡写真である。各分割記録要素の周縁部にエッジ状の段部は形成されておらず、各分割記録要素の側面のテーパ角も抑制され、良好な形状に加工されていることが確認された。

【0109】

又、連続記録層における磁気記録ディスクの端部からの距離とエッチングレートとの関係を図17に符号Aを付した曲線で示す。連続記録層のエッチングレートは微小なばらつきはあるものの、端部からの距離の大小により増減する傾向は認められなかった。尚、図17は、エッチングの進行が最も速い部位のエッチングレートを1として、各部位の相対的なエッチングレートを0～1の範囲で示したものであり、エッチングの進行速度の絶対値を示すものではない。

【0110】

又、レジスト層26、第1のマスク層22、連続記録層20（分割記録要素31）の底面のライン幅及びスペース幅（溝幅）を表1に示す。尚、レジスト層26の底面のライン幅及びスペース幅は、レジスト層加工工程（S102）後、且つ、第2のマスク層加工工程（S104）前に測定した。又、第1のマスク層22の底面のライン幅及びスペース幅は、レジスト層除去工程兼第1のマスク層加工工程（S106）後、且つ、連続記録層加

工工程 (S108) 前に測定した。又、連続記録層 20 (分割記録要素 31) の底面のライン幅及びスペース幅は、連続記録層加工工程 (S108) 後、且つ、第 1 のマスク層除去工程 (S110) 前に測定した。

【0111】

又、図 18 は、同磁気記録ディスクの MFM 像である。濃淡の度合いが異なる微細な斑点状の領域が均一に混在しており、磁気特性が良好であることが確認された。

【0112】

【表 1】

	実施例		比較例 1	
	ライン幅 (nm)	スペース幅 (nm)	ライン幅 (nm)	スペース幅 (nm)
レジスト層底面	75	75	75	75
第 1 のマスク層底面	78	72	92	58
分割記録要素底面	80	70	101	49

【0113】

【比較例 1】

上記実施例に対し、CO ガス等を反応ガスとする反応性イオンエッチングで連続記録層 20 を加工した。第 1 のマスク層 22 の材料は Ta (タンタル) として厚さは約 25 nm とし、SF₆ ガスを反応ガスとする反応性イオンエッチングで加工した。尚、分割記録要素 31 上に残存する第 1 のマスク層 22 も SF₆ ガスを反応ガスとするアッシングにより除去した。又、第 2 のマスク層 24 の材料は Ni (ニッケル) として厚さは約 10 nm とし、イオンビームエッチングで加工した。尚、反応性イオンエッチングでは、冷却機構を用いて被加工体 10 を冷却し、被加工体 10 を 1 個ずつ加工した。他の条件は上記実施例と同様とした。

【0114】

第 2 のマスク層 24、第 1 のマスク層 22、連続記録層 20 の加工における被加工体 10 の加工温度、加工に要した時間は次のとおりであった。

【0115】

第 2 のマスク層 24 : 約 90℃、約 30 秒 (Ar イオンビーム)
 第 1 のマスク層 22 : 120℃以下、約 20 秒 (反応ガス SF₆)
 連続記録層 20 : 250~300℃、約 60 秒 (反応ガス CO 等)

【0116】

連続記録層における磁気記録ディスクの端部からの距離とエッチングレートとの関係を図 17 に符号 B を付した曲線で示す。連続記録層のエッチングレートは端部に近いほど増大する傾向があることが確認された。即ち、被加工体の端部で他部よりもエッチングレートが大きく、加工寸法のばらつきが大きくなるため、例えば端部近傍の領域を磁気記録領域として使用できないことがあり、それだけ記録容量が低下することとなる。

【0117】

又、レジスト層 26、第 1 のマスク層 22、連続記録層 20 (分割記録要素 31) の底面のライン幅及びスペース幅 (溝幅) を表 1 に示す。

【0118】

又、同磁気記録ディスクの MFM 像を図 19 に示す。濃淡の度合いが異なる微細な領域が混在しているが一部は分割記録要素の周縁に沿って連続する線のような形状になっており、磁気的な劣化が生じていることが確認された。

【0119】

即ち、実施例の磁気記録ディスクは比較例 1 の磁気記録ディスクに対し、磁気特性が良好であることが確認された。これは実施例が比較例 1 よりも、各マスク層、連続記録層の加工に要する時間が短く、加工温度が低いためであると考えられる。尚、前述のように比較例 1 は連続記録層加工工程で冷却機構を用いて加工温度を抑制しており、仮に実施例と同様に冷却機構を用いずに反応性イオンエッチングで連続記録層を加工した場合、加工温度は更に上昇し、比較例 1 の磁気記録ディスクの磁氣的劣化は更に増大すると考えられる。

【0120】

又、実施例の磁気記録ディスクは比較例 1 の磁気記録ディスクに対し、分割記録要素の形状が安定しており、部位による形状のばらつきが小さかった。これは、実施例が比較例 1 よりも、部位による連続記録層のエッチングレートのばらつきが小さいためであると考えられる。

【0121】

又、表 1 に示されるように、実施例は比較例 1 に対し、レジスト層 26 の底面のスペース幅が等しいにも拘らず、連続記録層 20 (分割記録要素 31) の底面のスペース幅が大きかった。即ち、実施例は比較例 1 よりも、転写精度が良好であった。これは、実施例は第 1 のマスク層 22 の材料として DLC を用い、第 2 のマスク層 24 の材料として Si を用いているため、比較例 1 よりも、第 1 のマスク層 22、第 2 のマスク層 24 の膜厚が薄くできており、被加工部側面のテーパ角が抑制されたためであると考えられる。

【0122】

[比較例 2]

上記実施例に対し、第 1 のマスク層の厚さを 50 nm とし、磁気記録ディスクを製造した。その他の条件は上記実施例と同様とした。

【0123】

図 20 は、同磁気記録ディスクの分割記録要素の形状を拡大して示す顕微鏡写真である。各分割記録要素の周縁部に沿ってエッジ状の段部が形成されていることが確認された。

【0124】

[比較例 3]

上記実施例に対し、第 1 のマスク層 22、第 2 のマスク層 24 は形成しないで連続記録層 20 上に直接レジスト層 26 を形成し、レジスト層 26 をマスクとしてイオンビームエッチングにより連続記録層 20 を所定のパターンに加工して磁気記録ディスクを製造した。その他の条件は上記実施例と同様とした。

【0125】

図 21 は、同磁気記録ディスクの分割記録要素の形状を拡大して示す顕微鏡写真である。各分割記録要素の周縁部に沿って比較例 2 よりも若干突出量が大いエッジ状の段部が形成されていることが確認された。

【0126】

即ち、実施例の磁気記録ディスクは比較例 2 及び 3 の磁気記録ディスクに対し、分割記録要素の形状が良好であることが確認された。これは実施例は、連続記録層を被覆する被覆要素が比較例 2 及び 3 よりも薄いためであると考えられる。

【図面の簡単な説明】

【0127】

【図 1】本実施形態に係る磁気記録媒体の加工出発体である被加工体の構造を模式的に示す側断面図

【図 2】同被加工体を加工して得られる磁気記録媒体の構造を模式的に示す側断面図

【図 3】同磁気記録媒体を加工するための製造装置の構造を模式的に示すブロック図

【図 4】同製造装置に備えられたホルダの構造の概略を示す斜視図

【図 5】同製造装置に備えられた反応性イオンエッチング装置の構造を模式的に示す側面図

【図 6】同製造装置に備えられたイオンビームエッチング装置の構造を模式的に示す

側面図

【図 7】磁気記録媒体の製造工程を示すフローチャート

【図 8】レジスト層に分割パターンが転写された前記被加工体の形状を模式的に示す側断面図

【図 9】溝底面のレジスト層が除去された前記被加工体の形状を模式的に示す側断面図

【図 10】凹部底面の第 2 のマスク層が除去された前記被加工体の形状を模式的に示す側断面図

【図 11】溝底面の第 1 のマスク層が除去された前記被加工体の形状を模式的に示す側断面図

【図 12】分割記録要素が形成された前記被加工体の形状を模式的に示す側断面図

【図 13】分割記録要素上から第 1 のマスク層が除去された前記被加工体の形状を模式的に示す側断面図

【図 14】分割記録要素の間に非磁性体が充填された前記被加工体の形状を模式的に示す側断面図

【図 15】分割記録要素及び非磁性体の表面が平坦化された前記被加工体の形状を模式的に示す側断面図

【図 16】本発明の実施例の磁気記録ディスクの分割記録要素の形状を拡大して示す顕微鏡写真

【図 17】同磁気記録ディスク及び比較例 1 の磁気記録ディスクの端部からの距離と連続記録層のエッチングレートとの関係を示すグラフ

【図 18】同磁気記録ディスクの MFM 像

【図 19】比較例 1 の磁気記録ディスクの MFM 像

【図 20】比較例 2 の磁気記録ディスクの分割記録要素の形状を拡大して示す顕微鏡写真

【図 21】比較例 3 の磁気記録ディスクの分割記録要素の形状を拡大して示す顕微鏡写真

【図 22】従来のドライエッチングによる分割記録要素の周縁部への段部の形成過程を模式的に示す側断面図

【図 23】従来のドライエッチングによる側面がテーパ形状の分割記録要素の形成過程を模式的に示す側断面図

【符号の説明】

【0128】

10…被加工体

12…ガラス基板

14…下地層

16…軟磁性層

18…配向層

20…連続記録層

22…第 1 のマスク層

24…第 2 のマスク層

26…レジスト層

30…磁気記録媒体

31…分割記録要素

32…非磁性体

33…溝部

34…保護層

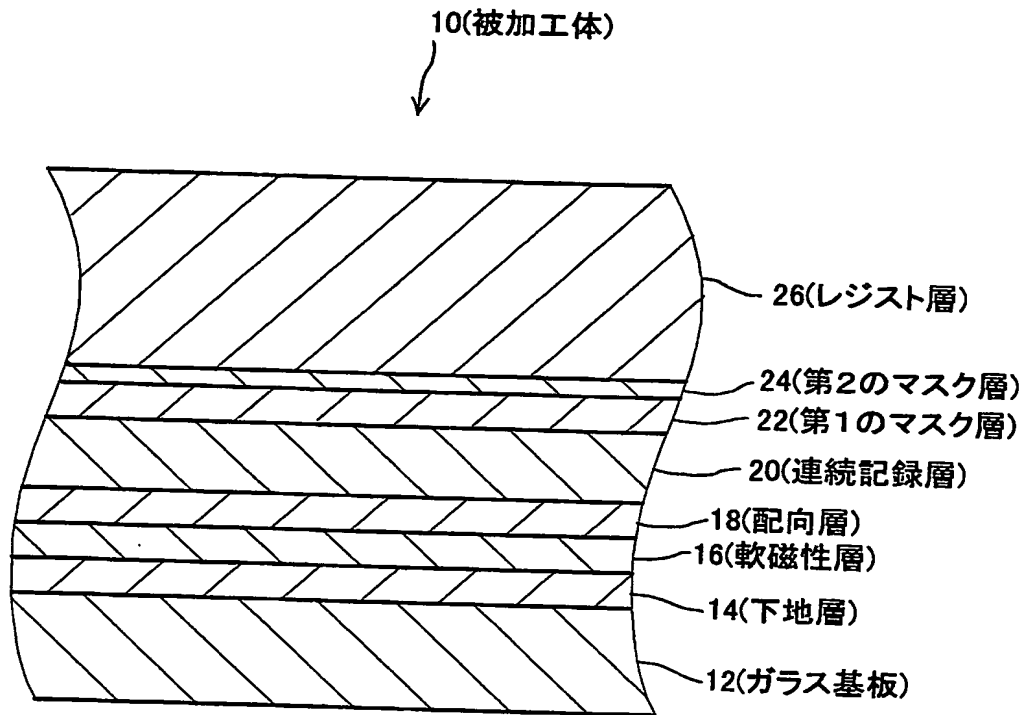
36…潤滑層

38…隔膜

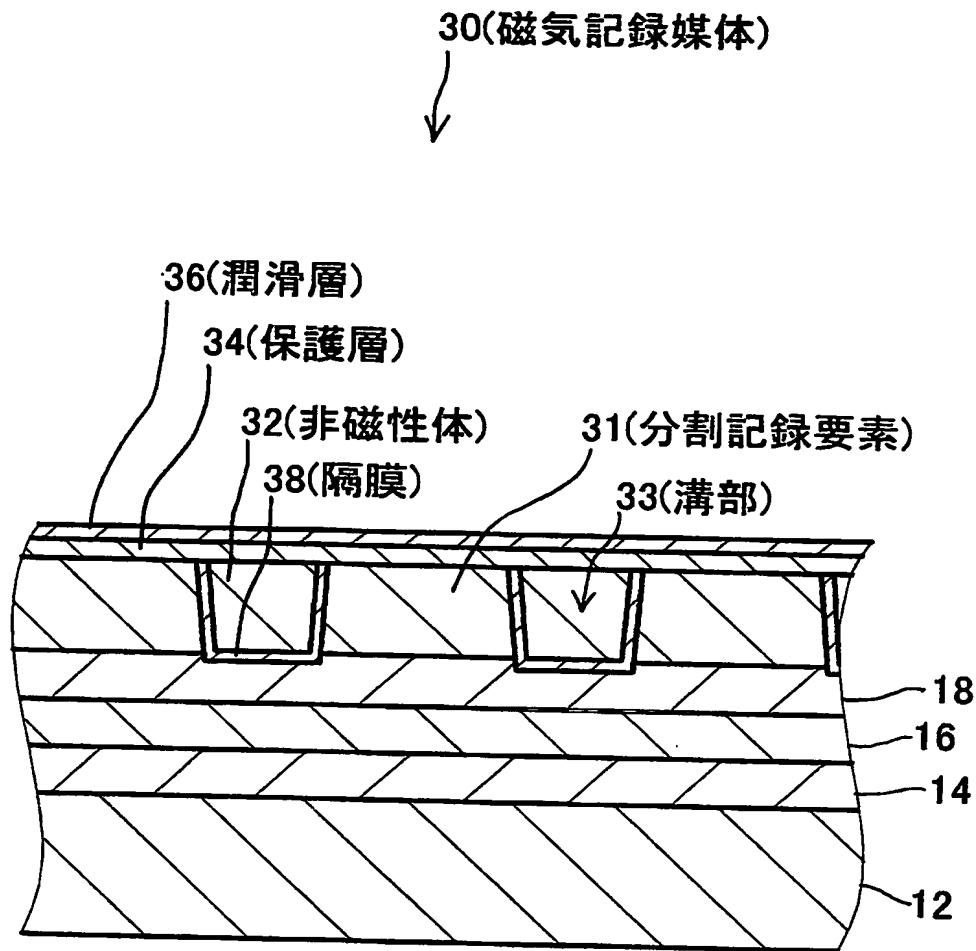
40…磁気記録媒体の製造装置

42...転写手
44、52...アッシング装置
46、48...反応性イオンエッチング装置
50...イオンビームエッチング装置
54...ドライ洗浄手段
56...隔膜形成手段
58...非磁性体充填手段
60...平坦化手段
62...保護層形成手段
64...潤滑層形成手段
66...真空保持手段
68...ホルダ
70...真空槽
72...真空ポンプ
S102...レジスト層加工工程
S104...第2のマスク層加工工程
S106...レジスト層除去工程、兼第1のマスク層加工工程
S108...連続記録層加工工程
S110...第1のマスク層除去工程
S112...ドライ洗浄工程
S114...隔膜形成工程
S116...非磁性体充填工程
S118...平坦化工程
S120...保護層形成工程
S122...潤滑層形成工程

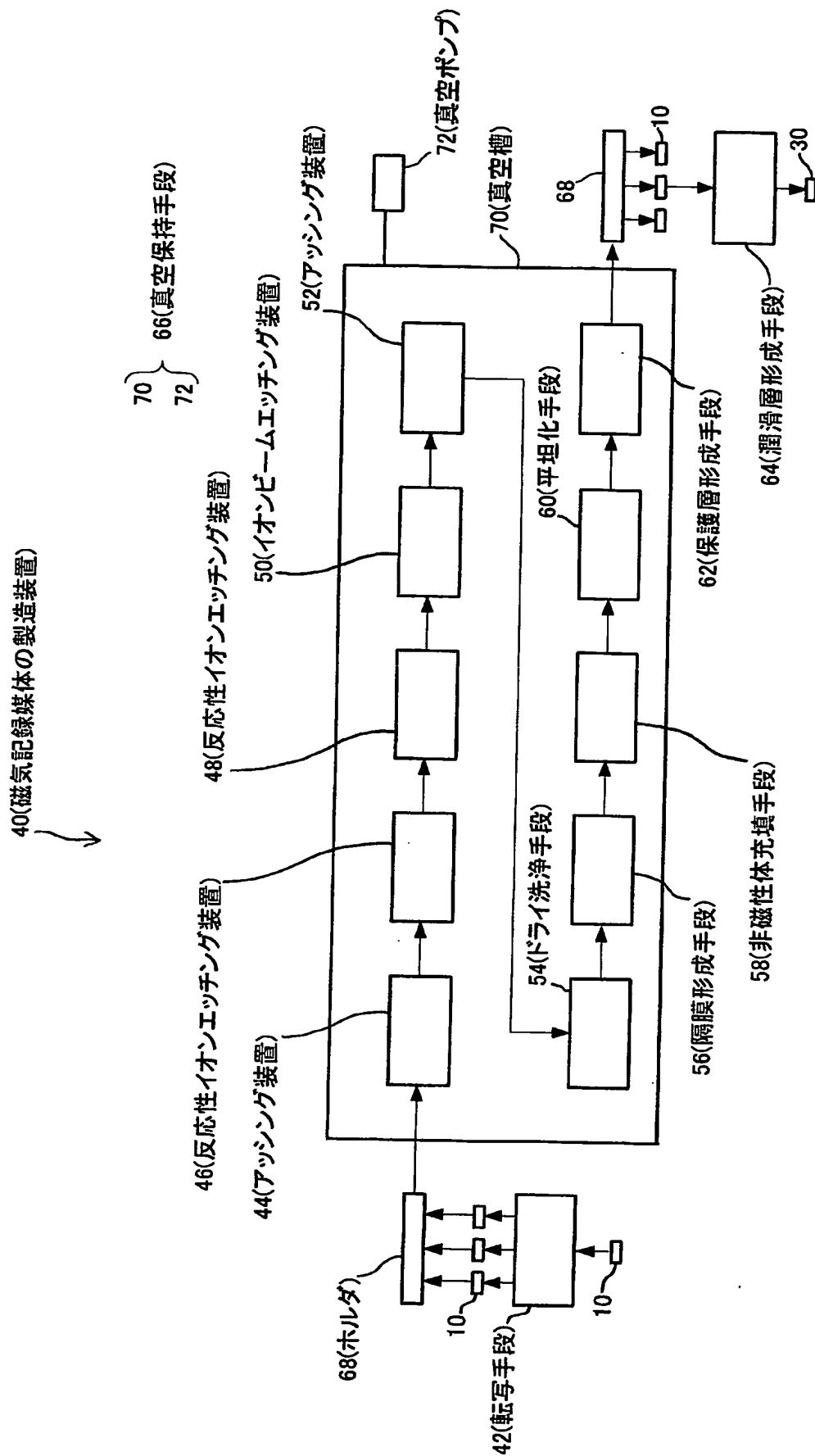
【書類名】 図面
【図 1】



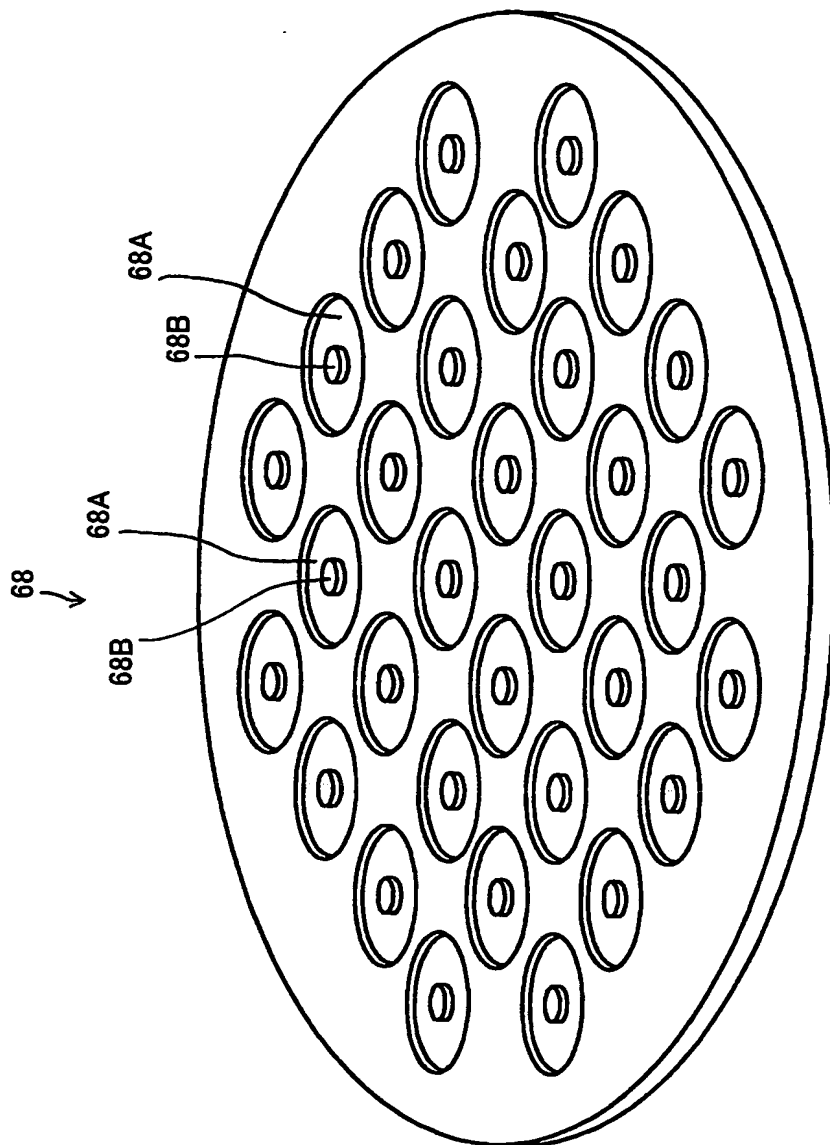
【図 2】



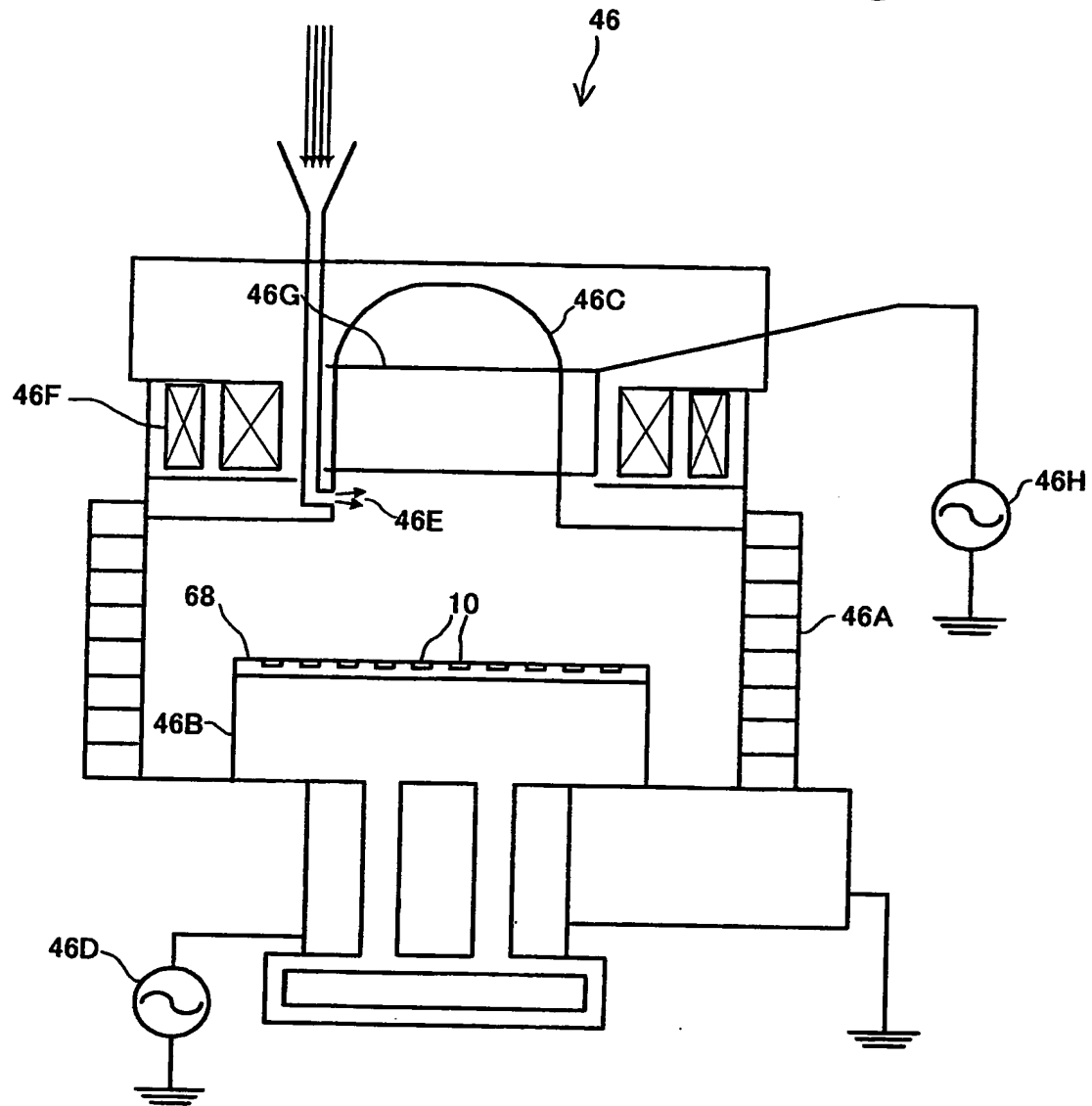
【図 3】



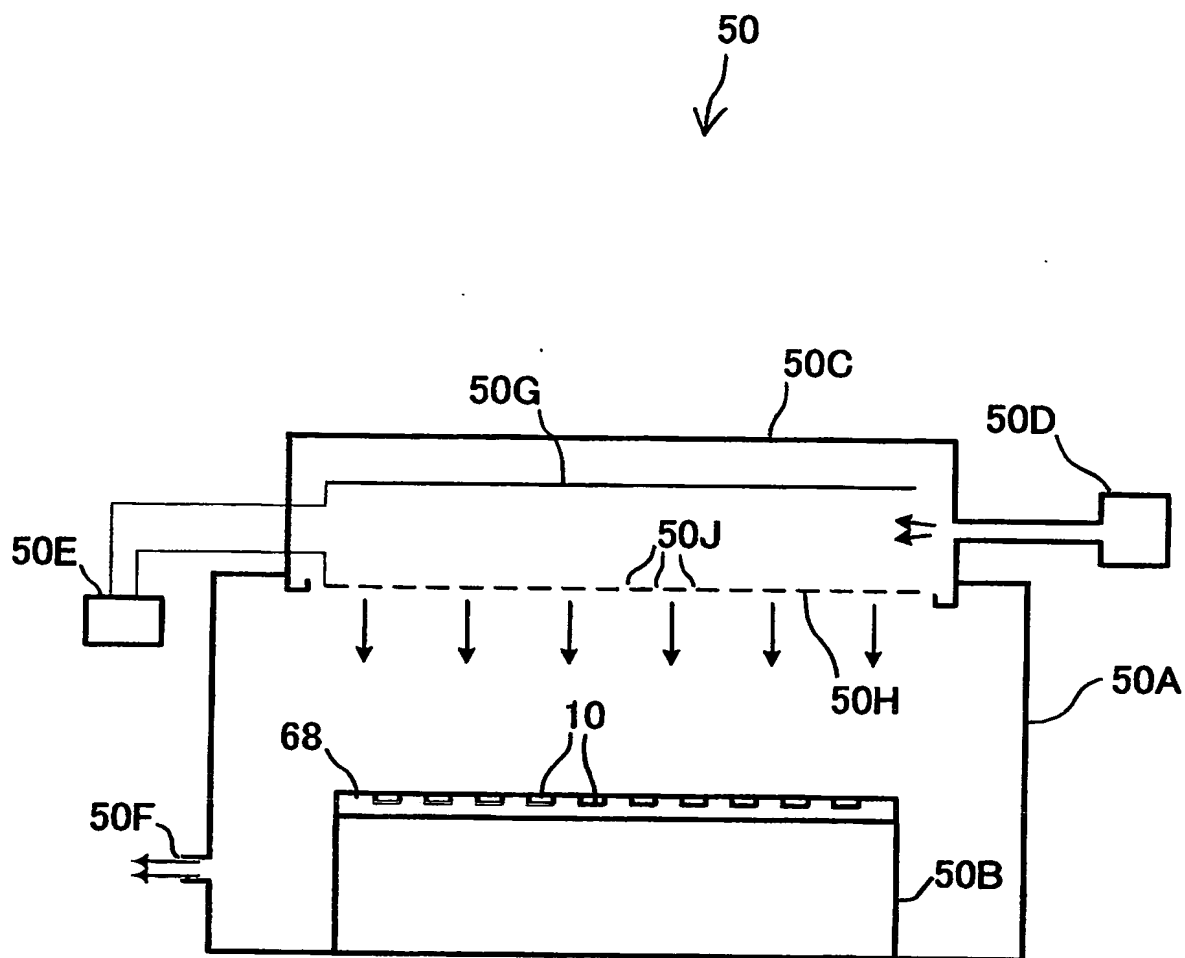
【図 4】



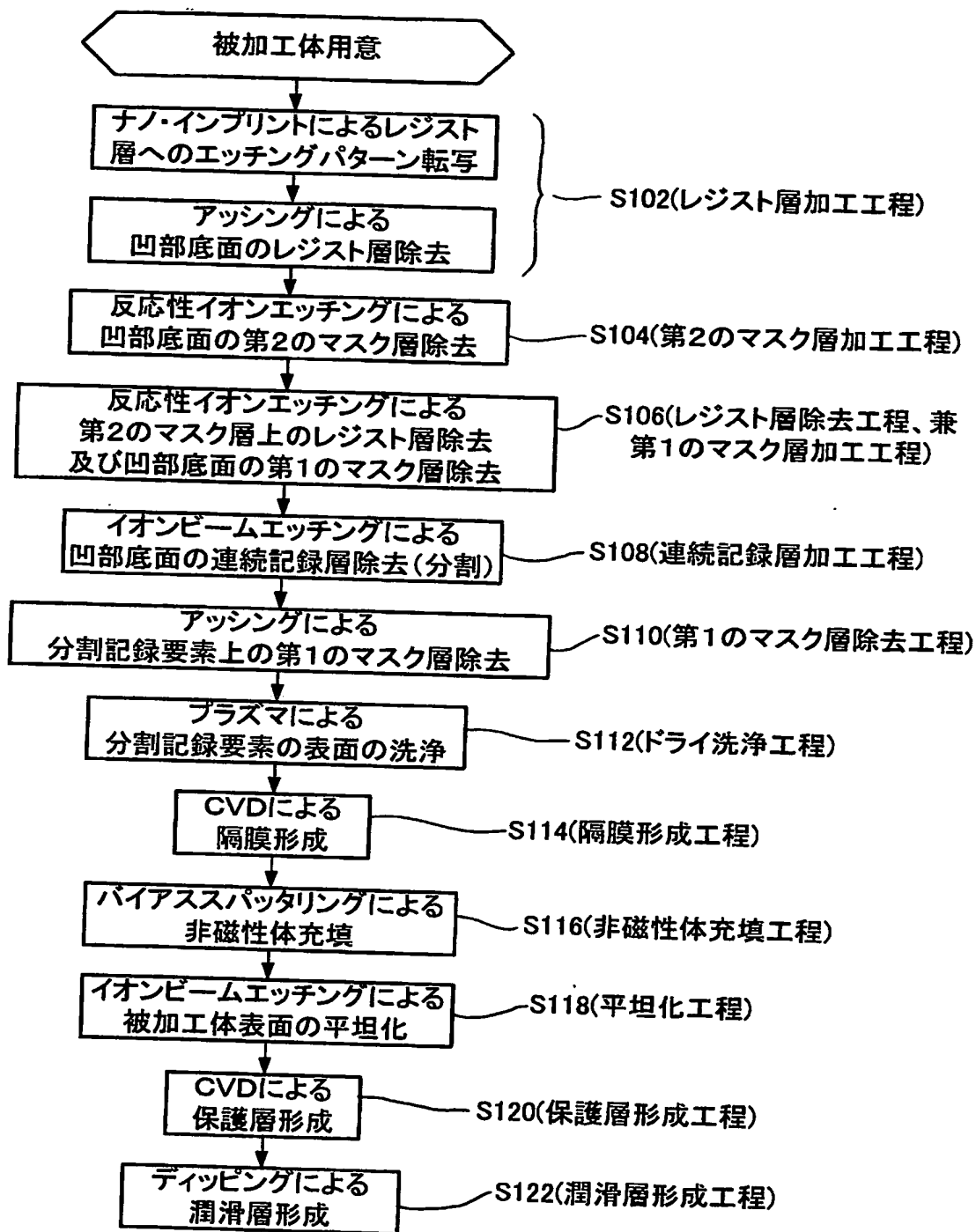
【図 5】



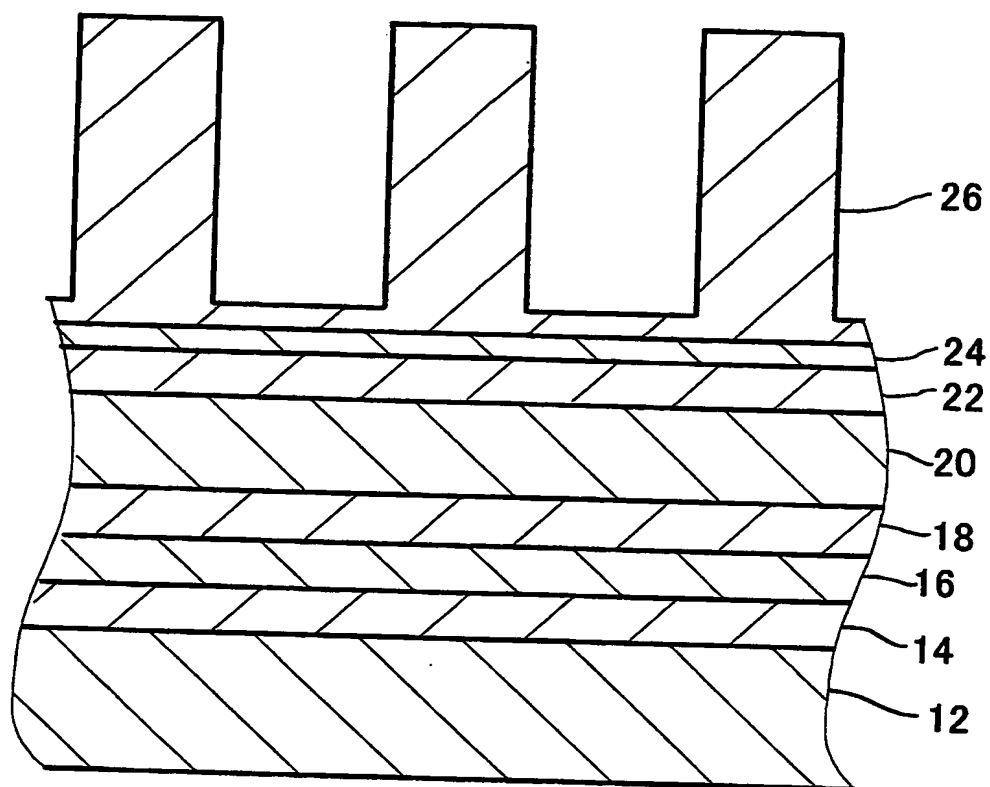
【図 6】



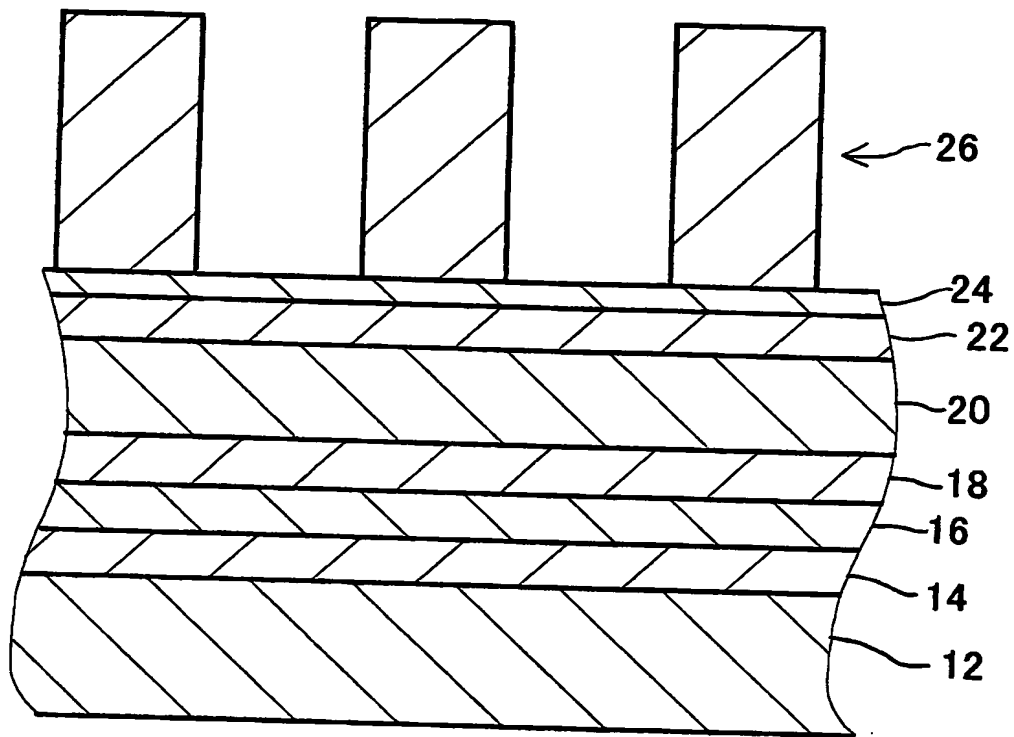
【図 7】



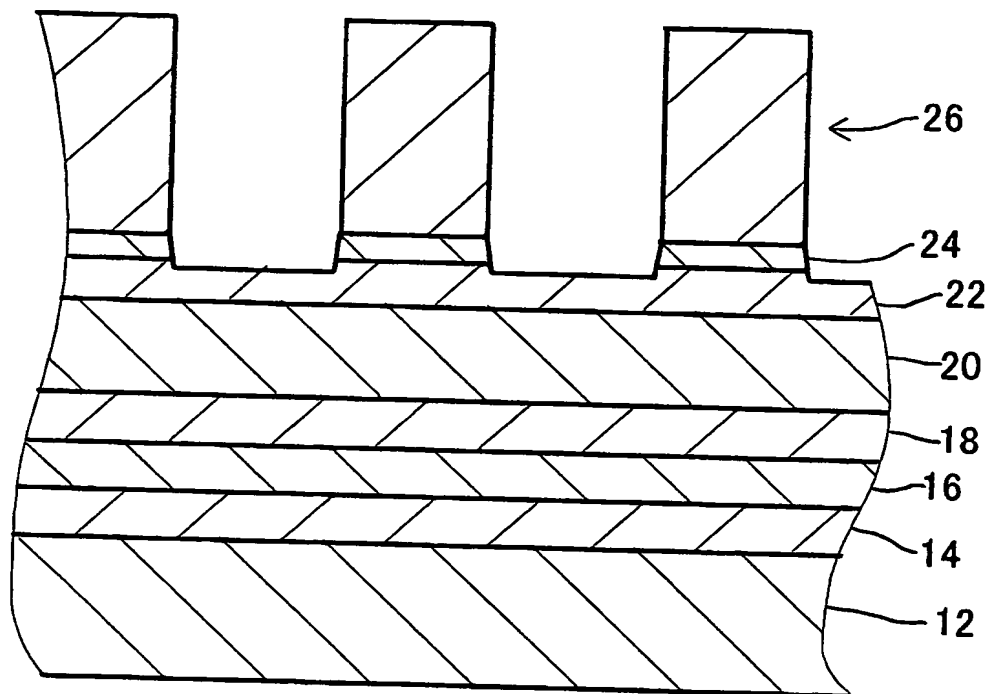
【図 8】



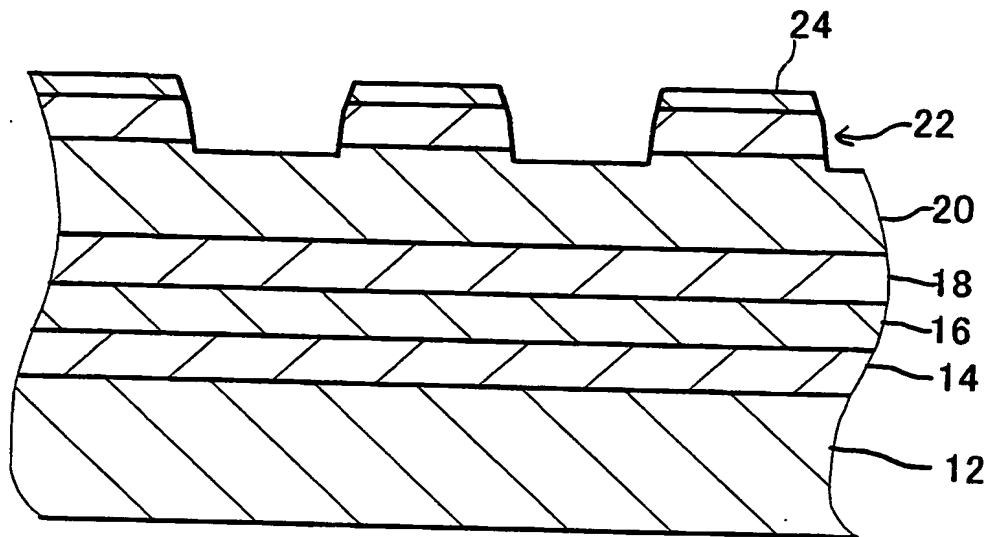
【図 9】



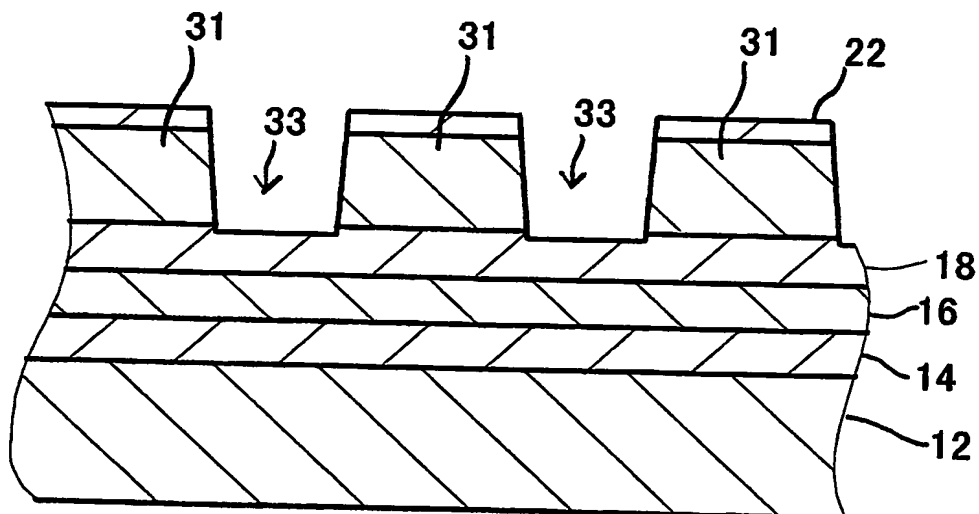
【図 10】



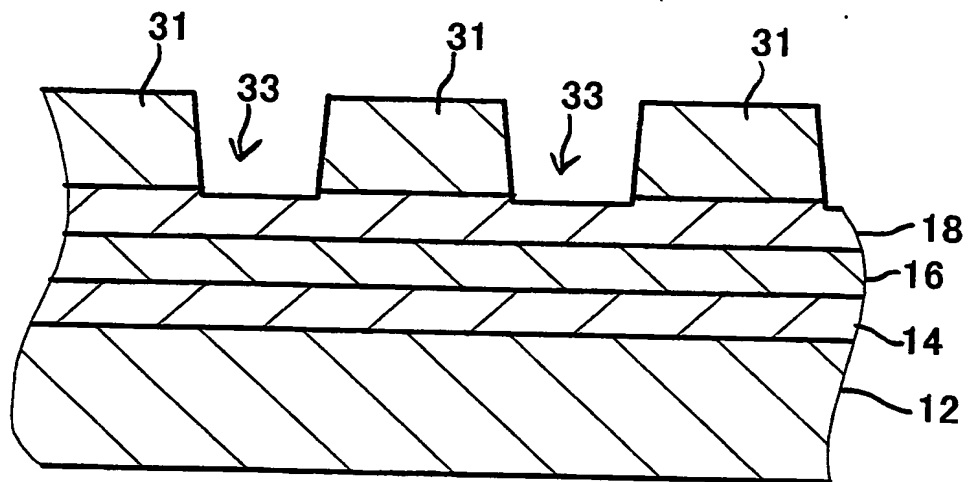
【図 11】



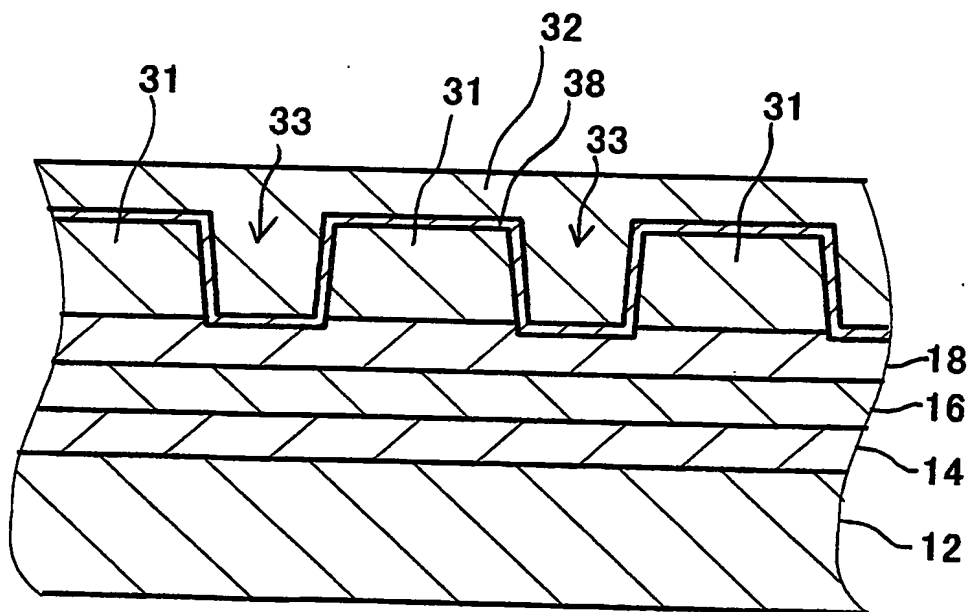
【図 12】



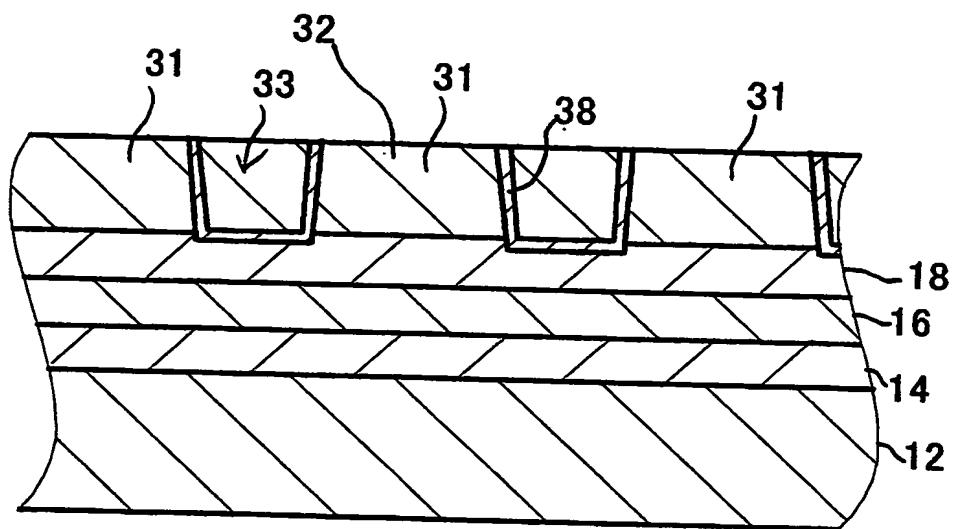
【図 13】



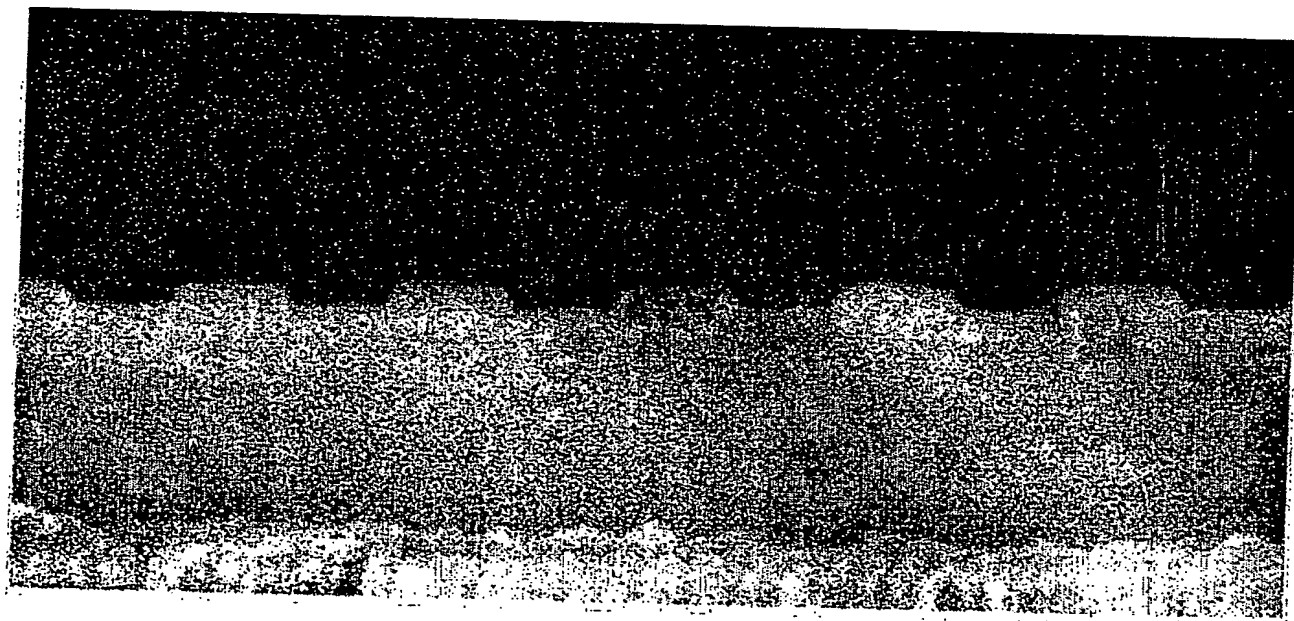
【図 14】



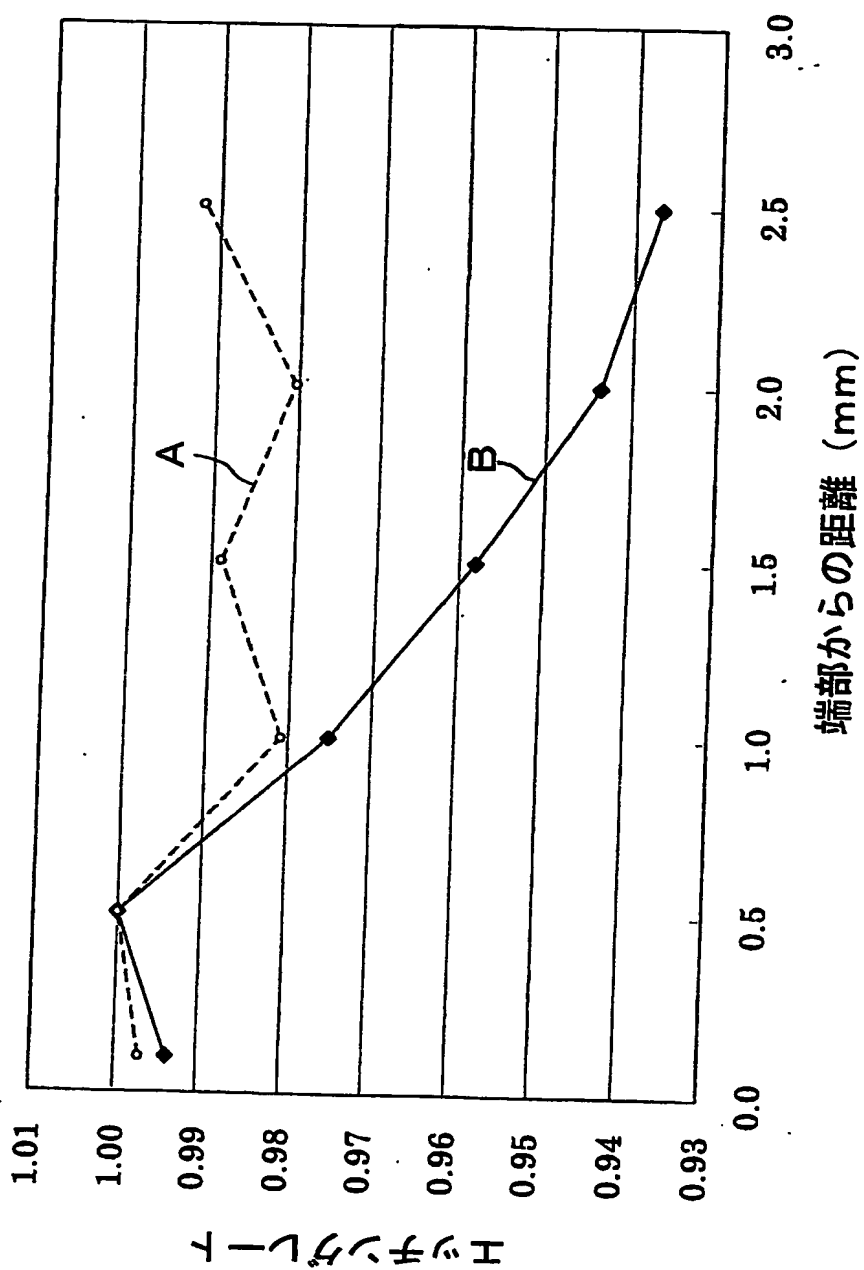
【図 15】



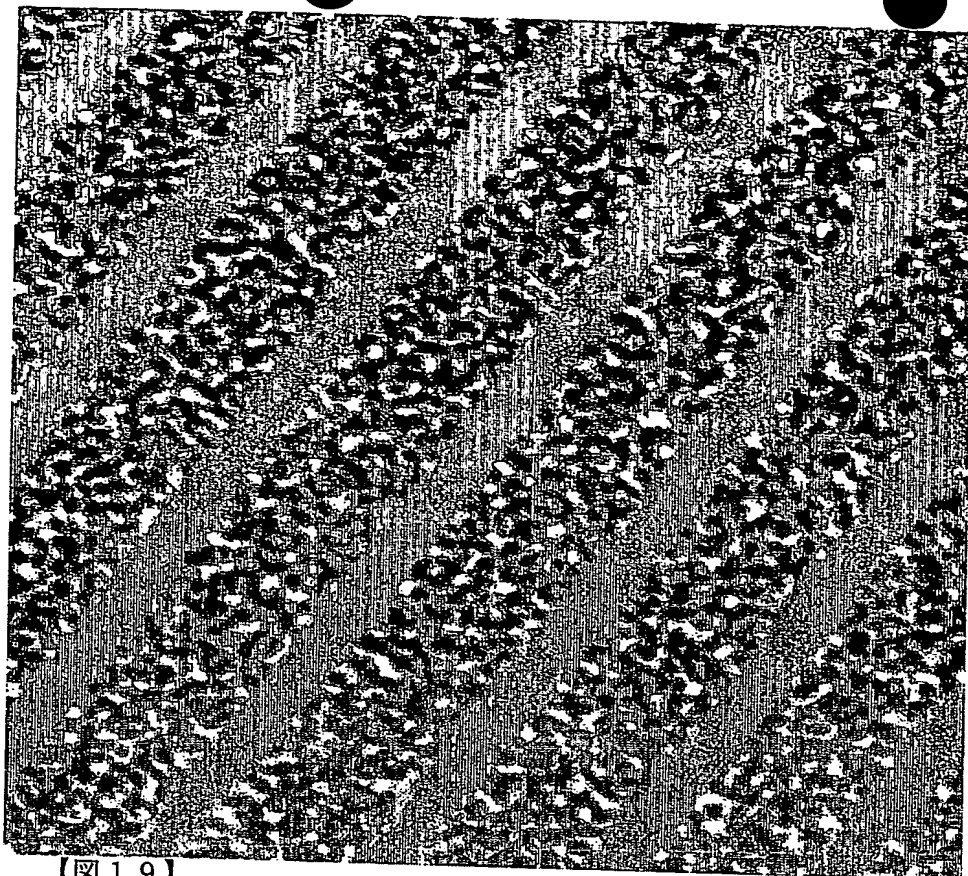
【図 16】



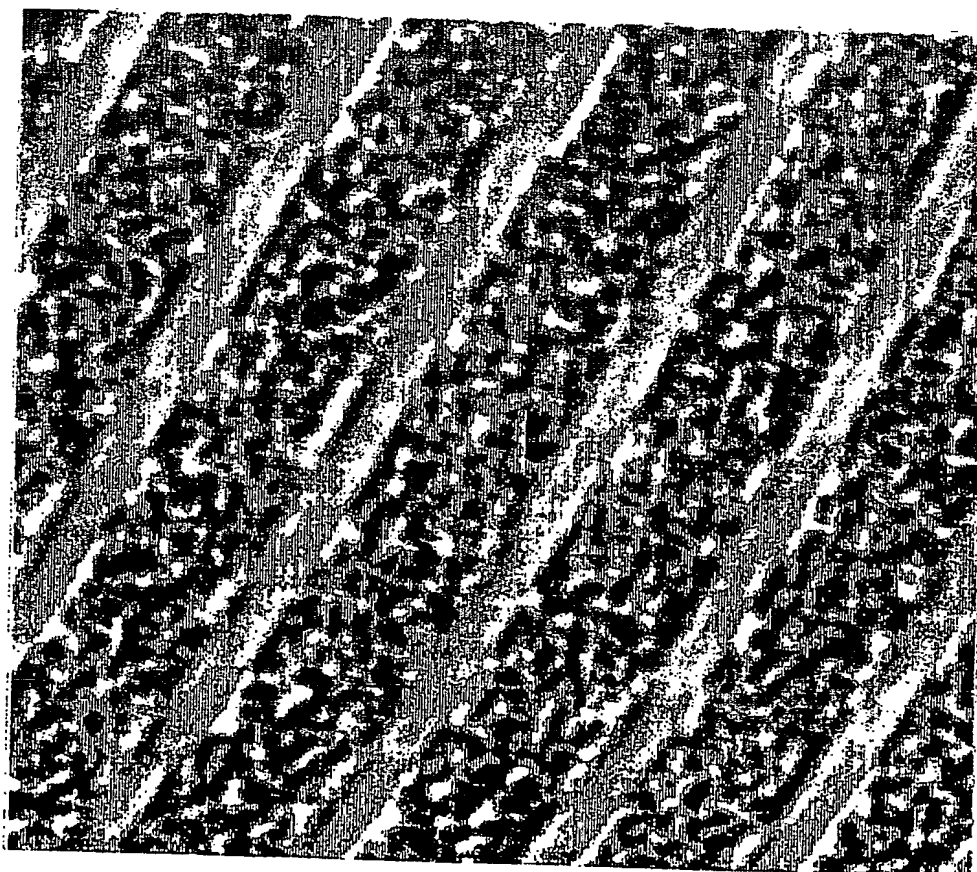
【図 17】



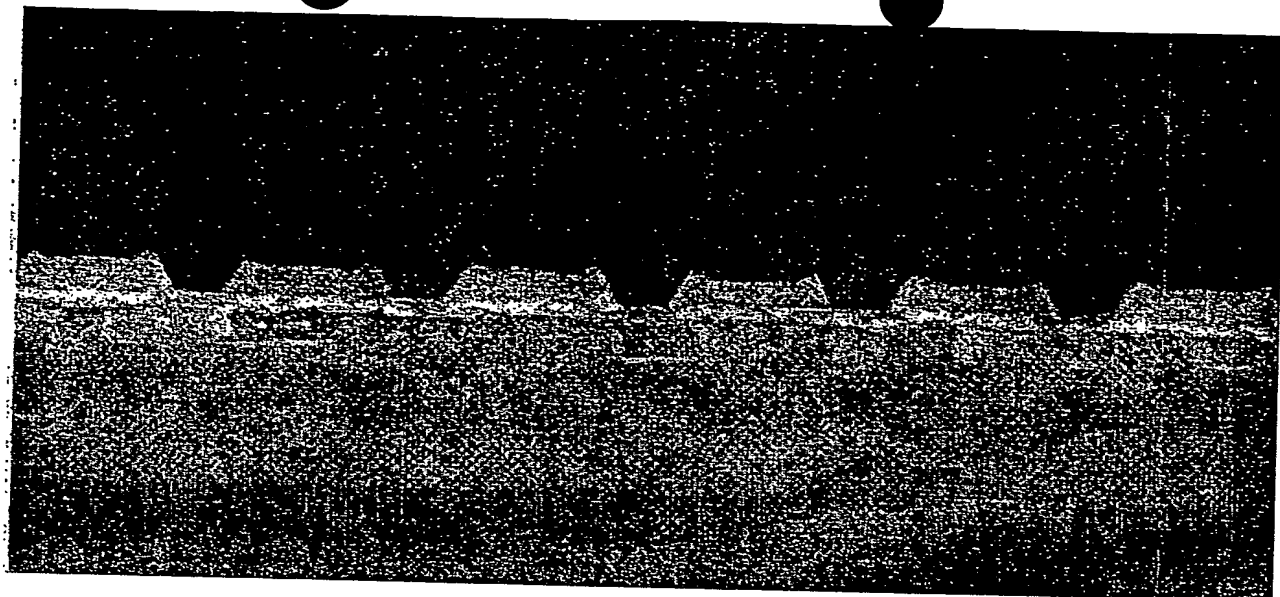
【図 18】



【図 19】



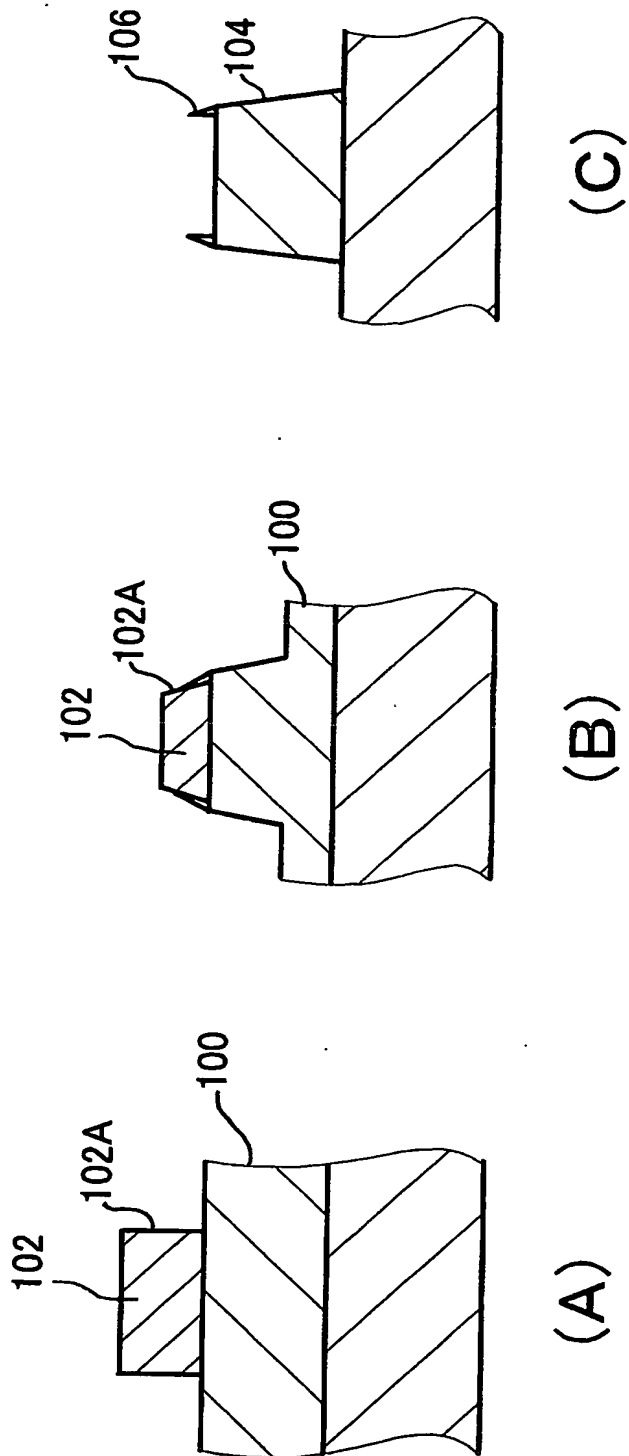
【図 20】



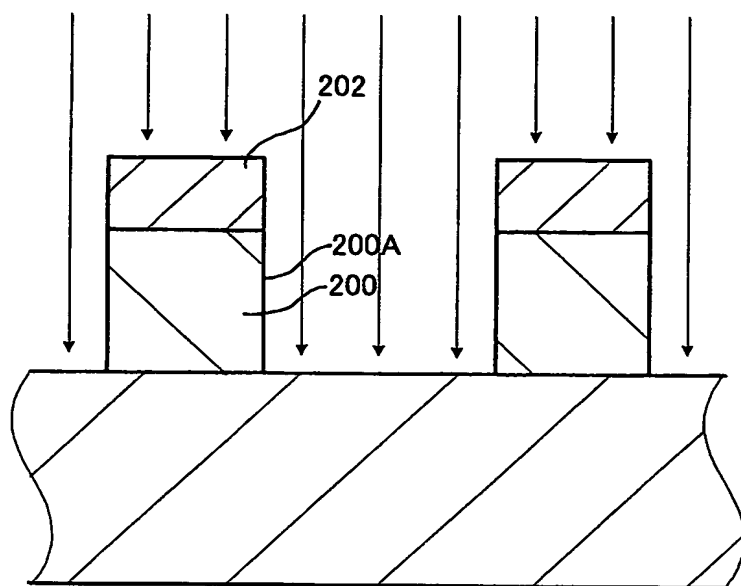
【図 21】



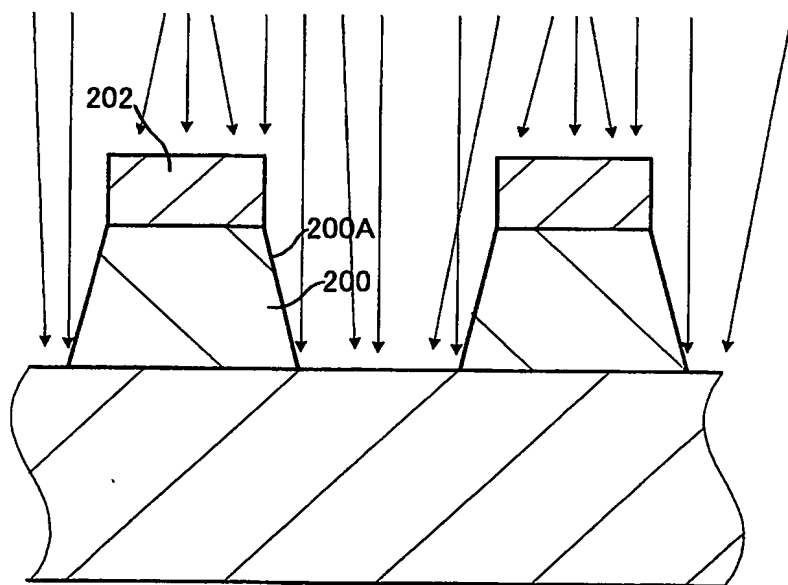
【図 22】



【図 23】



(A)



(B)

【書類名】 要約書

【要約】

【課題】 分割記録要素の加工形状のずれ、磁気的な劣化を抑制し、良好な磁気特性を有する磁気記録媒体を効率良く製造することができる磁気記録媒体の製造方法等を提供する。

【解決手段】 連続記録層 20 のドライエッチング手法としてイオンビームエッチングを用いる。又、レジスト層 26 を連続記録層 20 のドライエッチングの前に除去する。連続記録層を被覆する第 1 のマスク層の材料として、ダイヤモンドライクカーボンを用いる。

【選択図】 図 10

特願 2 0 0 3 - 2 8 3 5 6 7

出 願 人 履 歴 情 報

識別番号

[0 0 0 0 0 3 0 6 7]

1. 変更年月日

2 0 0 3 年 6 月 2 7 日

[変更理由]

名称変更

住 所

東京都中央区日本橋 1 丁目 1 3 番 1 号

氏 名

T D K 株式会社

**This Page is Inserted by IFW Indexing and Scanning
Operations and is not part of the Official Record**

BEST AVAILABLE IMAGES

Defective images within this document are accurate representations of the original documents submitted by the applicant.

Defects in the images include but are not limited to the items checked:

☐ BLACK BORDERS

☐ IMAGE CUT OFF AT TOP, BOTTOM OR SIDES

☐ FADED TEXT OR DRAWING

☒ BLURRED OR ILLEGIBLE TEXT OR DRAWING

☐ SKEWED/SLANTED IMAGES

☒ COLOR OR BLACK AND WHITE PHOTOGRAPHS

☐ GRAY SCALE DOCUMENTS

☒ LINES OR MARKS ON ORIGINAL DOCUMENT

☐ REFERENCE(S) OR EXHIBIT(S) SUBMITTED ARE POOR QUALITY

☐ OTHER: _____

IMAGES ARE BEST AVAILABLE COPY.

As rescanning these documents will not correct the image problems checked, please do not report these problems to the IFW Image Problem Mailbox.